สมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วย ในโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้ง

สราวุฒิ บุตรวัง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา วิทยานิพนธ์ของ สราวุฒิ บุตรวัง ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิท**ยา**นิพนธ์

.....อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชัยศักดิ์ อิสโร)

(ดร.มติ ห่อประทุม)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.......................ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.วินัคดา วงศ์วิริยะพันธ์)

Che H.L. กรรมการ

(ดร.มติ ห่อประทุม)

/ hours_____กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.การะเกค เทศศรี)

คณะวิทยาศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

......คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เอกรัฐ ศรีสุข) วันที่. 24...เดือน. <u>กรณา ณ</u>.พ.ศ. 2560

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ชัยศักดิ์ อิสโร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คร.มติ ห่อประทุม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางที่ถูกค้อง ตลอคจนแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ด้วยความละเอียคถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยคีเสมอมา รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่มีส่วนสนับสนุน เครื่องมือและสถานที่ตลอคระยะเวลาในการทำวิจัย รวมทั้งขอบคุณ ผู้วิจัยจาก (NECTEC) ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือผู้วิจัยจนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยคี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณมา ในโอกาสนี้

ขอกราบขอบพระกุณบิดา มารดา และญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้วิจัยในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเพื่อน ๆ สาขาวิชาฟิสิกส์ทุกท่านที่ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูเวทิตาแค่ บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีการศึกษาและ ประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

สราวุฒิ บุตรวัง

56910226: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

ท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยในโตรเจน/ ตกเกลือบไอระเหยทางเกมี/ การปลดปล่อย คำสำคัญ: อิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้า/ ความต้านทานไฟฟ้า

สราวุฒิ บุตรวัง: สมบัติทางไฟฟ้าและการปลคปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนา โนคาร์บอนที่เจือด้วยในโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้ง (ELECTRICAL AND ELECTRON FIELD ELECTRON EMISSION PROPERTIES OF VERTICALLY ALIGNED NITROGEN DOPED CARBON NANOTUBES) คณะกรรมการควบคมวิทยานิพนธ์: ชัยศักดิ์ อิสโร. DR. RER. NAT., มติ ห่อประทุม, Ph.D. 54 หน้า. ปี พ.ศ. 2560.

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการเจือในโตรเจนที่มีต่อโครงสร้าง รูปร่าง สมบัติทาง ้ไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนการ์บอนที่สังเกราะห์ลงบนวัสดุรองรับซิลิกอน ้ด้วยวิธีตกเคลือบไอระเหยทางเคมีที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 900 องศาเซลเซียส โดยใช้สารตั้งต้น เฟอร์ โรซีนกับอิมิคา โซลเป็นแหล่งกำเนิดการ์บอนและ ใน โตรเจน จากผลของภาพถ่ายจากกล้อง ้งลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าทกตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ท่อนาโนคาร์บอนมี การเรียงตัวในแนวตั้งกับวัสคุรองรับและมีความสูงของท่อเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณของสารตั้ง ต้นอิมิคาโซล โดยผลของโครงสร้างภายในจากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ้ผ่าน (TEM) แสดงให้เห็นว่าการเจืออะตอมในโตรเจนเข้าไปในท่อนาโนคาร์บอนมีผลทำให้ ้โครงสร้างภายในท่อมีลักษณะ โครงสร้างแบบปล้องไผ่และมีผนังท่อที่บางเมื่อเทียบท่อนาโน ้ การ์บอนที่ไม่ถูกเจือด้วยในโตรเจน จากการศึกษาองก์ประกอบของธาตุภายในท่อนาโนคาร์บอน ด้วยเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี (XPS) พบว่าท่อนาโนคาร์บอนถูกเจือด้วยความ เข้มข้นเชิงอะตอมของในโตรเจนสงสคอย่ที่ 4.06 %

การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานทางไฟฟ้ากับฟังก์ชันของอุณหภูมิของท่อนาโน ้ การ์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน จากผลการทดลอง การลดลงของความต้านทานเมื่ออุณหภูมิ เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจากสมบัติการเป็นสารกึ่งตัวนำที่เกิดขึ้นในตัวอย่าง จากการศึกษาการ ้ปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้านั้น ผลของการเจือในโตรเจนทำให้ท่อนาโนการ์บอนมี การปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าที่ดีขึ้น โดยมีค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดที่ ้ต่ำลงและผลของการเจือในโตรเจนยังทำให้ค่าฟังก์ชันงาน ($oldsymbol{\phi}$) มีค่าที่ลคลง

56910226: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: NNITROGEN DOPED CARBON NANOTUBES/ CHEMICAL VAPOR DEPOSITION/ ELECTRON FIELD EMISSION/ RESISTANCE SARAWOOT BOOTWANG: ELECTRICAL AND ELECTRON FIELD EMISSION PROPERTIES OF VERTICALLY ALIGNED NITROGEN DOPED CARBON NANOTUBES. ADVISORY COMMITTEE: CHAISAK ISSRO, DR. RER. NAT., MATI HORPRATHUM, Ph.D. 54 P. 2017.

This research is aimed to study the effect of nitrogen doped atom on structure, morphology, electrical and electron filed emission properties of carbon nanotubes (CNTs) were synthesized onto silicon wafer substrates by the chemical vapor deposition method at temperature growth of 900 °C using ferrocene and imidazole at the carbon and nitrogen sources. The all scanning electron microscope (SEM) images of synthesized CNTs were shown the vertically aligned carbon nanotubes on substrates and increasing of a length with increasing imidazole precursor. The morphologies were investigated by transmission electron microscope (TEM) images of CNTs showed the doped nitrogen atom into carbon nanotubes yielded the bamboo-like structure and thin nanotube walls when compared with pristine CNTs. The elemental analysis of carbon nanotubes were characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It was found that the highest atomic concentration of the nitrogen doping was 4.06%.

The variation of electrical resistance as a function to temperature of carbon nanotubes was done for all the synthesized samples. From this experimental result, the decrease in resistance with increasing temperature caused semiconducting properties was occurred in sample. From the electron field emission study, it follows that the carbon nanotubes by effect of doped nitrogen atom are improved electron field emission with decrease turn-on field and decreases the work function.

สารบัญ

ł	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญ	R
สารบัญตาราง	ୟ
สารบัญภาพ	ឍ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	3
1.5 ขอบเขตของการวิจัย	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 รูปแบบทั่วไปท่อนาโนการ์บอน	5
2.2 ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยในโตรเจน	7
2.3 การปลดปล่อยอิเล็กตรอน	16
2.4 ค่าฟังก์ชันงาน (work function)	18
2.5 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน	20
2.6 การประยุกต์ใช้วัสคุสำหรับเป็นแหล่งปลคปล่อยอิเล็กตรอน	23
2.7 การวัดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยวิธีสองโพรบและสภาพต้านทานโดย	
วิธีสี่โพรบ	24
3 วิธีการคำเนินการวิจัย	
3.1 ระบบ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมท่อนาโนคาร์บอน	26
3.2 วิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน	27

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์สมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโน	
คาร์บอน	28
3.4 ขั้นตอนการเตรียมและวัดความต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอน	29
4 ผลการวิจัย	
4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของท่อนาโนการ์บอนด้วยกล้อง	
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน	30
4.2 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน	37
4.3 ผลการวัดความต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอน	42
5 อภิปรายและสรุปผล	45
บรรณานุกรม	47
ประวัติย่อของผู้วิจัย	54

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยในโตรเจนด้วยวิธี CVD	11
2	แสดงค่าฟังก์ชันงาน (work function) ในหน่วย eV ของธาตุต่าง ๆ	19
3	แสดงเงื่อนไขการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน	27
4	แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของตัวอย่างที่สังเกราะห์ได้	32
5	แสดงข้อมูลปริมาณเปอร์เซ็นต์โดยจำนวนอะตอมของรูปแบบโครงสร้าง	
	ในโตรเจนของตัวอย่าง N2-N4	34
6	แสดงค่าฟังก์ชันงาน (Work function; $oldsymbol{\phi}$) ที่ใช้ในการคำนวณและค่า eta ของท่อ	
	นาโนคาร์บอนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ	39
7	แสดงค่าฟังก์ชันงานและค่าที่ใช้ในการคำนวณ	42
8	แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้	43

สารบัญภาพ

	หน้า
Chiral vector เมื่อ a1 และ a2 เป็นเวกเตอร์ lattice ของแผ่นกราฟีน	5
ลักษณะของการม้วนตัวของแผ่นกราฟืนทำให้ท่อนาโนการ์บอนมีสมบัติเป็น	
โลหะหรือสารกึ่งตัวนำ	6
ลักษณะของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังชั้นเดียวโครงสร้างต่าง ๆ อาร์มแชร์ ซิก	
แซก และ ใครัล	6
ลักษณะของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น	7
แผนภาพระบบการสังเคราะห์แบบวิธีอาร์คดิสชาร์จ	8
แผนภาพระบบการสังเคราะห์ แบบวิธีระเหยด้วยแสงเลเซอร์	9
แผนภาพระบบการสังเคราะห์แบบวิธีการตกสะสมใอระเหยทางเคมี	10
แบบจำลองการเกิดท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวแบบ Vapor-Liquid-Solid	
(VLS)	12
รูปแบบจำลองของการเกิดท่อนาโนคาร์บอน (a) Tip-growth และ	
(b) Base-growth	13
ชนิดพันธะที่เป็นไปได้ที่เกิดบนระนาบแกรไฟต์คาร์บอน (a) pyridine-like N,	
(b) pyrrole-like N, (c) substitutional N, (d) nitrile $-C \equiv N$, (e) amine - NH2,	
(f) single N pyridinic vacancy, (g) triple N pyridinic vacancy และ	
(h) interstitial N	14
แสดงชนิดพันธะกับก่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมการ์บอนจับกับอะตอม	
ในโตรเจน	14
ลักษณะการแทรกตัวของอะตอมในโตรเจนบริเวณผนังท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้น	
เคียว	15
การจำลองการเข้าไปแทรกตัวในปล้องไผ่ของอะตอมในโตรเจน	15
ความสัมพันธ์ของปริมาณในโตรเจนกับระยะห่างระหว่างปล้องใผ่ เมื่อปริมาณ	
ในโตรเจนในท่อนาโนการ์บอนเพิ่มขึ้นระยะห่างระหว่างปล้องจะลดลง	16
รูปแบบไคอะแกรมของการปลคปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อน	17
รูปแบบไคอะแกรมของการปลคปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามไฟฟ้า	18
	Chiral vector เมื่อ a1 และ a2 เป็นเวกเตอร์ lattice ของแผ่นกราฟีน

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพ	ที่	ห
17	แสดงภาพ SEM ของท่อนาโนการ์บอนปลายปิดในรูป a และ c ท่อปลายเปิดในรูป	
	b และ d ความยาวของท่อ 110±2 nm	
18	ค่าความหนาแน่นกระแสภายใต้สนามไฟฟ้าที่วัดได้ของตัวอย่าง (a) ท่อปลายปิด	
	และ (b) ท่อปลายเปิด สี่เหลี่ยมเล็กคือค่าที่ได้จากสมการ Fowler-Nordheim	
19	ค่าความหนาแน่นกระแสภายใต้สนามไฟฟ้าที่วัดได้ของตัวอย่างที่ใช้เป็นตัว	
	ปลดปล่อยในรูปแบบต่าง ๆ จากงานวิจัยของ Cheng และ Zhou	
20	การปลคปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของวัสดุต่าง ๆ	
21	แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าโดยวิธีสี่โพรบ	
22	แสดงโครงสร้างของชั้นสารตัวอย่างชั้นบาง ๆ ที่อยู่บนแผ่นผลึกฐานรอง	
23	แสดงรูประบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน	
24	แผนภาพแสดงการทดสอบสมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโน	
	การ์บอน	
25	แสดง PCB สำหรับการทดสอบวัดค่าต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอน	
26	ภาพถ่ายจาก SEM ของตัวอย่าง (a) N0, (b) N1, (c) N2, (d) N3 และ (e) N4 โดย	
	ขีดสเกลของภาพอยู่ที่ 2 ใมโครเมตร	
27	ภาพถ่ายจาก TEM ที่กำลังขยายต่ำและกำลังขยายสูงของตัวอย่าง	
	(a-b) N0, (c-d) N1, (e-f) N2, (g-h) N3 และ (i-j) N4	
28	XPS องก์ประกอบของธาตุ (a) เป็นการแสดงองก์ประกอบของธาตุในท่อนาโน	
	คาร์บอน (b), (c) และ (d) แสดงพลังงานยึคเหนี่ยวพันธะของในโตรเจนในท่อนา	
	โนคาร์บอนของตัวอย่าง N2 N3 และ N4	
29	สเปกตรัมรามานของท่อนาโนการ์บอนของตัวอย่าง N0, N1, N2 ,N3 และ N4	
30	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนกับ	
	สนามไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งบนวัสดุรองรับ	
31	ความสัมพันธ์ของกราฟในรูปสมการของ Fowler-Nordheim (F-N) ของท่อนาโน	
	การ์บอนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งบนวัสคุรองรับ	
32	ความสัมพันธ์ปริมาณการเจือในโตรเจนกับค่า field enhancement factor	

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
33	กราฟ (a) E _{cut off} ของตัวอย่าง N0, (b) E _{cut off} ของตัวอย่าง N2, (c) E _{cut off} ของตัวอย่าง	
	N4, และกราฟ (d) ค่า E _F	41
34	ค่ากวามต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอนตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง	42
35	ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนตัวอย่างในช่วง	
	อุณหภูมิ 25 – 130 °C	43

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้อปกรณ์ปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ถกนำมาใช้ในอปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เช่น เป็นแหล่งกำเนิคอิเล็กตรอนในหลอครั้งสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และจอภาพแสคงข้อมูล แบบความละเอียดสูง โดยวัสดุสำหรับนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน ต้องกำนึงถึง ้ประสิทธิภาพของการปลคปล่อยอิเล็กตรอน ราคาประหยัด มีอายการใช้งานที่นาน และมีต้นทนการ ้ผลิตต่ำ แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนส่วนใหญ่มักจะใช้ทั้งสเตน เนื่องจากทั้งสเตนเป็นโลหะที่มีเลข ้อะตอมสูง มีจำนวนอิเล็กตรอนมาก หาได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ แต่ข้อเสียของทั้งสเตนคือต้องใช้ พลังงานกระต้นที่ทำให้อิเล็กตรอนหลดจากผิวก่อนข้างสง ปัจจบันการศึกษาหาวัสดอปกรณ์ ้สำหรับนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนได้รับความสนใจจากนักวิจัยจำนวนมาก จากการศึกษา ของกลุ่มวิจัยหลายกลุ่ม วัสดการ์บอนชนิดท่อนาโนการ์บอน (Carbon nanotubes, CNTs) จัดเป็น ้วัสดุตัวเลือกหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจต่อนักวิจัยในการศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับเป็น แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน เพราะท่อนาโนการ์บอน มีลักษณะเด่นในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ดี ภายใต้สนามไฟฟ้าที่ต่ำ มีความเสถียรของกระแสไฟฟ้าที่วัด (Bonard, Kind, Stockli, & Nilsson, 2001) อีกทั้งยังมีสมบัติพิเศษที่น่าสนใจ เช่น สมบัติเชิงกล คือมีโครงสร้างระดับนาโนที่มีความ แข็งแกร่ง น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อแรงคึงได้มากและมีสมบัติทางไฟฟ้าที่เด่น ้ คือเป็นได้ทั้งวัสดุตัวนำหรือกึ่งตัวนำไฟฟ้า สามารถนำความร้อนได้ดี จากผลของการศึกษาสมบัติ ้ของท่อนาโนการ์บอนของนักวิจัยกลุ่มต่าง ๆ ทำให้บางกลุ่มเริ่มให้ความสนใจในที่จะพัฒนาและ ้ศึกษาปรับเปลี่ยนสมบัติการปลคปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนให้ดีขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ ้ได้แก่ การเจือท่อนาโนการ์บอนด้วยอะตอมไนโตรเจน อะตอมของไนโตรเจนที่ถกเจือจะมีผลต่อ ้ปริมาณจำนวนพาหะ โดยอะตอมในโตรเจนที่เจือเข้าไปทำให้เกิดอิเล็กตรอนโดเนอร์ ส่งผลให้ท่อ นาโนการ์บอนมีสมบัติเค่นในการนำไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งผลของการเจืออะตอมไนโตรเจนยังทำให้ พลังงานที่ใช้ในการยึดอิเล็กตรอนไว้ที่ผิวหรือค่าฟังก์ชันงาน (work function) ของท่อนาโน คาร์บอนมีค่าลดลง (Luo, Lim, Tian, Shang, & Lin, 2011) ส่งผลให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดได้ง่าย จึ้น

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่การที่ท่อนาโนการ์บอนถูกเจือด้วยอะตอมไนโตรเจนเข้าไปเท่านั้นที่ สามารถปรับเปลี่ยนกุณสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนให้ดีขึ้น ผลของการปลูกท่อนาโนการ์บอน ที่มีลักษณะเรียงตัวในแนวตั้ง ยังช่วยให้ท่อนาโนคาร์บอนปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ดีขึ้นเช่นกัน (Cheng & Zhou, 2003) เนื่องจากการปลูกท่อนาโนคาร์บอนให้มีลักษณะเรียงตัวในแนวตั้งจะช่วย เพิ่มพื้นที่สำหรับปลดปล่อยอิเล็กตรอน โดยในงานวิจัยนี้จะทำการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่ ถูกเจือด้วยในโตรเจนให้มีลักษณะเรียงตัวในแนวตั้ง เพื่อศึกษาผลของการเจือในโตรเจนที่มีต่อ ลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนและสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโน การ์บอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับการประยุกต์ใช้เป็น แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนในเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลของการเจือในโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน

 เพื่อศึกษาสนามไฟฟ้าเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโน การ์บอนที่เจือด้วยปริมาณในโตรเจนที่แตกต่างกัน

 เพื่อศึกษาความต้านทานทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วย ในโตรเจนที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผู้วิจัยได้แบ่งการคำเนินงานของวิทยานิพนธ์เป็น 3 ขั้นตอน คือ

 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เงือด้วยในโตรเงน ด้วยวิธีตกเคลือบไอระเหยทาง เคมี โดยใช้สารตั้งต้นชนิดของแข็ง

 การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนที่ ถูกเจือด้วยในโตรเจน

การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน

สำหรับขั้นตอนแรก เริ่มต้นด้วยการศึกษาเทคนิคการสังเคราะห์แบบวิธีตกเคลือบไอ ระเหยทางเคมี จากนั้นทำการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจน โดยทำการศึกษาผล ของการเจือไนโตรเจนในท่อนาโนคาร์บอนที่มีผลต่อโครงสร้างและรูปร่างของท่อนาโนคาร์บอน โดยท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ผ่านและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อตรวจสอบโครงสร้างและรูปร่างของท่อนา โนคาร์บอน วิเคราะห์ความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของท่อด้วยเทคนิครามานสเปคโตรสโคปี รวมทั้งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในโตรเจนและธาตุอื่น ๆ ที่เจือบนท่อนาโนคาร์บอนด้วยเทคนิค เอกซ์-เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี งั้นตอนที่สอง นำท่อนาโนการ์บอนที่สังเกราะห์ได้ที่เงื่อนไขต่าง ๆ จากการสังเกราะห์ ในขั้นตอนที่หนึ่ง ทำการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าของท่อนาโน การ์บอนที่ถูกเจือไนโตรเจน ศึกษาผลของสนามไฟฟ้าเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอน ของท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยปริมาณไนโตรเจนที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่สาม นำท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ที่เงื่อนไขต่าง ๆ ทำการศึกษาสมบัติ ทางไฟฟ้าโดยศึกษาจากความต้านทานทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วย ในโตรเจนที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสังเคราะห์ CNTs ด้วยวิธีตกเคลือบไอระเหยทางเคมี

 เข้าใจลักษณะทางโครงสร้างและรูปร่างของ CNTs ที่แสดงผลต่อการปลดปล่อย อิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้า

 สามารถเข้าใจพื้นฐานและเงื่อนไขของการผลิตตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้เป็นตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอนในเครื่องมือต่าง ๆ ได้

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

ในโครงงานวิจัยนี้สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน ด้วยวิธีตก เคลือบสะสมไอระเหยทางเคมี (Chemical vapor deposition, CVD) ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ซึ่งสารตั้งด้นที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอนและในโตรเจนเป็นของแข็ง คืออิมิดาโซล (Imidazole) ผสมกับเฟอร์โรซีน (ferrocene)

ศึกษาผลของท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน

 ก็กิษาลักษณะทางโครงสร้าง รูปร่าง และความสมบูรณ์ของท่อนาโนคาร์บอนที่ถูก เจือด้วยในโตรเจนที่ปริมาณที่แตกต่างกัน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเทคนิครามานสเปคโตรสโคปี

2. ศึกษาหาปริมาณธาตุในโตรเจนที่เจือบนท่อนาโนการ์บอนด้วยเทคนิคเอกซ์-เรย์ โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) สึกษาสมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนที่เงื่อนไข ปริมาณการเงือไนโตรเงนที่แตกต่างกัน ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิเคียวกัน แต่ละตัวอย่างจะใช้พื้นที่ใน การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนที่เท่ากันที่ 0.5 cm × 0.5 cm
 สึกษาความต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเงือและไม่ถูกเงือด้วย ในโตรเงนภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 รูปแบบทั่วไปของท่อนาโนการ์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes, CNTs) ค้นพบครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1991 โดย นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อ สุมิโอะ อีจิมะ (Sumio Iijima) โดยท่อนาโนคาร์บอนเกิดขึ้นจากการ ม้วนตัวเข้าหากันของแผ่นกราฟีนม้วนเชื่อมติดกันเป็นรูปทรงกระบอก โดยที่อะตอมของการ์บอน เชื่อมต่อกันด้วยพันธะแบบ sp2 โครงสร้างของท่อนาโนการ์บอนแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังชั้นเดียว (Single wall carbon nanotube, SWNTs)

เป็นท่อนาโนการ์บอนที่ประกอบด้วยชั้นของการ์บอนเพียง 1 ชั้น สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ชนิดตามการม้วนตัวของแผ่นกราฟืน ได้แก่ Armchair (n,m), Zigzag (n,0), และ Chiral (n,m) ก่าดัชนี (n,m) จะเป็นตัวบอกรูปแบบของม้วนตัวของท่อนาโนการ์บอนแบบผนังชั้นเดียวใน รูปแบบใด อธิบายได้ด้วยเวกเตอร์ **C**_h (Chiral vector) รวมทั้งลักษณะ โกรงสร้างที่พิจารณาจาก เวกเตอร์สามารถอธิบายได้ว่าท่อนาโนการ์บอนมีสมบัติเป็นโลหะหรือสารกึ่งตัวนำ

$$\boldsymbol{C}_{\boldsymbol{h}} = n\boldsymbol{a}_1 + n\boldsymbol{a}_2 \equiv (n,m) \tag{1}$$

$$|n - m| = 3p, p \neq 0, metallic$$
(2)

$$|n - m| = 3p \pm 1$$
, $p \neq 0$, semiconducting (3)



ภาพที่ 1 Chiral vector เมื่อ a1 และ a2 เป็นเวกเตอร์ lattice ของแผ่นกราฟืน (Lau & Hui, 2002)

รูปแบบของ Armchair ค่าดัชนี n มีค่าเท่ากับ m หรือ (n=m) โดยขนาดมุมมีค่าเท่ากับ 30° ส่วนรูปแบบของ Zigzag ค่าดัชนี m มีค่าเท่ากับ 0 หรือ (n,0) โดยขนาดมุมมีค่าเท่ากับ 0° และ รูปแบบ Chiral จัดเรียงตัวในแบบ (n,m) โดยขนาดมุมเท่ากับ

$$\theta = \tan^{-1}\left[\frac{\sqrt{3m}}{(m+2n)}\right] \tag{4}$$



ภาพที่ 2 ลักษณะของการม้วนตัวของแผ่นกราฟืนทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีสมบัติเป็นโลหะหรือ สารกึ่งตัวนำ (Lau & Hui, 2002)



ภาพที่ 3 ลักษณะของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังชั้นเดียวโครงสร้างต่าง ๆ อาร์มแชร์ ซิกแซก และ ใครัล (Ávila & Lacerda, 2008)

 ก่อนาโนการ์บอนแบบผนังหลายชั้น (Multi walled carbon nanotube, MWNTs) เป็นท่อนาโนการ์บอนที่ประกอบด้วยชั้นของการ์บอนซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น ซึ่งมี สมบัติบางอย่างกล้ายกับท่อนาโนการ์บอนผนังชั้นเดียว เช่น Young's modulus แบบผนังชั้นเดียวมี ก่าประมาณ 1 TPa ส่วนแบบผนังหลายชั้นอยู่ที่ 0.95 TPa (Yu, Lourie, Dyer, Moloni, & Ruoff, 2000) แต่จะมีสมบัติที่เด่นกว่ากือ Tensile strength ผนังชั้นเดียวจะมีก่าอยู่ที่ 13–53 GPa ของผนัง หลายชั้นจะมีก่าถึง 150 GPa (Demczyk, Wang, Cumings, Han, & Ritchie, 2002)



ภาพที่ 4 ลักษณะของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น (Li & Chou, 2003)

2.2 ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยในโตรเจน

2.2.1 วิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยในโตรเจน

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสมบัติของท่อ นาโนคาร์บอนที่ต้องการ แต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งวิธีการ สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่

2.2.1.1 วิธีอาร์คดิสชาร์จ (Arc Discharge)

วิธีอาร์กดิสชาร์จ (Arc Discharge) เป็นวิธีเริ่มแรกที่ใช้สังเคราะห์ท่อนาโน การ์บอน (Iijima, 1991) และเจือธาตุอะตอมอื่นเข้าไปในท่อนาโนคาร์บอน แต่เดิมนั้นใช้ในการ สังเคราะห์ฟูลเลอรีน การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์กดิสชาร์จ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลับ ตั้งแต่ 20-200 แอมแปร์ ที่ความต่างศักย์ตกกร่อมแท่งแกรไฟต์สองแท่ง ประมาณ 20-40 โวลต์ ภายใต้บรรยากาศแก๊สฮีเลียมและในโตรเจน ที่ความดันระหว่าง 100-500 Torr และเมื่อ ขั้วอิเล็กโทรดมีความร้อนสูง โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการกวบคุมอยู่ที่ประมาณ 1500-3000 องศา เซลเซียส ส่งผลให้แท่งแกรไฟต์ระเหยกลายเป็นไอ ทำให้การ์บอนเกิดการแตกตัวกลายเป็นสถานะ พลาสมาร้อน เกิดการควบแน่นและก่อตัวใหม่เป็นท่อนาโนการ์บอนที่ขั้วแกโทด ขณะเกิดตัวเป็น ท่อนาโนการ์บอนมีอะตอมไนโตรเจนบางส่วนเข้าไปแทรกตัวและเกิดพันธะกับการ์บอนที่บริเวณ ผนังท่อ ทำให้ท่อนาโนการ์บอนถูกเจือด้วยไนโตรเจน ท่อนาโนการ์บอนที่สังเกราะห์ได้นี้ อาจเกิด เป็นท่อนาโนการ์บอนแบบผนังหลายชั้นหรือแบบผนังชั้นเดียว ขึ้นอยู่กับโลหะที่ใช้เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Droppa และคณะ ทำการทดลองโดยใช้โลหะคะตะลิสต์ จำพวก เหล็ก นิกเกิล และ โกบอลต์ เพื่อสังเกราะห์ท่อนาโนการ์บอนผนังแบบชั้นเดียวที่เจือในโตรเจนด้วย วิธีอาร์กดิสชาร์จ ภายใต้กวามดันที่ใช้ในการสังเกราะห์ท่อนาโนการ์บอนอยู่ที่ 300 Torr และใช้ ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรดอยู่ที่ 6 มิลลิเมตร (Droppa , Hammer, Carvalho, & Alvarez, 2002) พบว่าในการสังเกราะห์ท่อนาโนการ์บอนด้วยวิธีนี้ ท่อนาโนการ์บอนที่ได้จะมีขนาดไม่สม่ำเสมอ และมีสิ่งเจือปน เช่น อสัณฐานของการ์บอนด้อนข้างมาก



ภาพที่ 5 แผนภาพระบบการสังเคราะห์แบบวิธีอาร์คดิสชาร์จ (Merchan, Saveliev, Kennedy, & Jimenez, 2010)

2.2.1.2 วิธีระเหยด้วยแสงเลเซอร์ (Laser vaporization)

วิธีระเหยด้วยแสงเลเซอร์ (Laser vaporization) (Guo, Nikolaev, Thess, Colbert, & Smalley, 1995) เป็นการใช้เลเซอร์ที่มีพลังงานสูงยิงกระทบแท่งการ์บอนที่ผสม โลหะ ภายใต้ อุณหภูมิประมาณ 1200 ถึง 1500 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดก๊าซการ์บอนและอะตอมการ์บอนที่ร้อน ขึ้น และใช้ก๊าซเฉื่อย เช่น อาร์กอนหรือในโตรเจนไปกวาดเอาท่อนาโนที่เกิดขึ้นออกจากเตาเผาแล้ว นำไปหล่อเย็นที่ตัวกักเก็บที่ทำจากทองแดงด้านนอกเตาเผา ซึ่งการสังเกราะห์ด้วยวิธีนี้จึงดีกว่าวิธี อาร์กดิสชาร์จ เนื่องจากท่อนาโนการ์บอนกวามบริสุทธิ์สูงกว่า แต่มีก่าใช้จ่ายในการสังเกราะห์ ก่อนข้างสูง ท่อนาโนการ์บอนที่ได้จึงมีปริมาณและกุณภาพที่ดีกว่า



ภาพที่ 6 แผนภาพระบบการสังเคราะห์แบบวิธีระเหยด้วยแสงเลเซอร์ (Merchan, Saveliev, Kennedy, & Jimenez, 2010)

2.2.1.3 วิธีการตกสะสมใอระเหยทางเคมี

ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตกสะสมไอระเหยทางเคมี (Chemical vapor deposition, CVD) ใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ประมาณ 500 - 1200 องศา เซลเซียส ทำให้สารตั้งต้นที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดการ์บอนและ ในโตรเจนแตกตัวเป็นโมเลกุล ผลของ การแตกตัวโมเลกุลของการ์บอนจะเกิดการแพร่กระจายตัวบนผิวของโลหะกะตะลิสต์ โมเลกุลจะ เคลื่อนตัวมายังด้านข้างรวมตัวเกิดเป็นท่อนาโนการ์บอน ในกระบวนการเกิดเป็นท่อโมเลกุลของ ในโตรเจนก็มีการเข้าไปแทรกเกิดพันธะกับโมเลกุลอะตอมของการ์บอนที่บริเวณผนังท่อทำให้ท่อ นาโนการ์บอนถูกเจือด้วยในโตรเจน วิธีการตกไอระเหยทางเคมีสามารถแบ่งตามวิธีการแยกก๊าซ ไฮโดรการ์บอนและวิธีการเตรียมโลหะตัวเร่งปฏิกิริยาออกเป็น 5 วิธี คือ การตกสะสมไอระเหยทาง เกมีด้วยความร้อน (Thermal CVD) การตกสะสมไอระเหยทางเคมีของพลาสมา (Plasma enhanced CVD, PECVD) การตกสะสมไอระเหยทางเกมีแบบขดลวดกวามร้อน (hot filament CVD) การตก สะสมไอระเหยทางเกมี (Vapor phase growth CVD) และการตกสะสมไอระเหยทางเกมีของก๊าซ การ์บอนไดออกไซด์กวามดันสูง (high pressure carbon oxide CVD, HiPCo) ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันมาก ในปัจจุบันคือ การตกสะสม ไอระเหยทางเกมีด้วยความร้อน เนื่องจากสามารถสังเกราะห์ได้ทั้งท่อ นาโนชนิดผนังชั้นเดียวและผนังหลายชั้น ส่วนการตกสะสมไอระเหยทางเกมีของพลาสมานั้น สามารถสังเคราะห์ท่อนาโนได้ที่อุณหภูมิต่ำที่สุด (ต่ำกว่า 400 องศาเซลเซียส) แต่ท่อนาโนที่ได้ ส่วนมากจะเป็นชนิดผนังหลายชั้นเท่านั้น



ภาพที่ 7 แผนภาพระบบการสังเคราะห์แบบวิธีการตกสะสมไอระเหยทางเคมี (Merchan, Saveliev, Kennedy, & Jimenez, 2010)

วิธีการตกสะสมไอระเหยทางเกมี (Chemical vapor deposition, CVD) ซึ่งวิธีการนี้ สามารถผลิตท่อนาโนการ์บอนได้ในปริมาณมาก สามารถควบคุมขนาดและความยาวของท่อนาโน การ์บอนได้ การสังเกราะห์ท่อนาโนการ์บอนด้วยวิธี CVD ปกติจะใช้ความร้อนจากเตาช่วยในการ สังเกราะห์ ซึ่งความร้อนจะทำให้สารตั้งต้นที่มีส่วนประกอบของการ์บอนแตกตัวเป็นโมเลกุล การ์บอนและตกลงบนวัสดุรองรับที่มีโลหะเร่งปฏิกิริยา เช่น เหล็ก (Fe) นิกเกิล (Ni) และ โคบอลต์ (Co) ทำให้เกิดการก่อตัวเป็นท่อนาโนการ์บอน การเกิดเป็นท่อนาโนการ์บอนที่มีขนาดต่างกันก็ ขึ้นกับขนาดตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นกัน

การเลือกใช้สารในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนขึ้นอยู่กับเทคนิคและเงื่อนไข ในการสังเคราะห์ โดยในงานวิจัยของ Ghosh et al. (2010) ได้ทำการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่ เจือด้วยในโตรเจน โดยใช้สารที่เป็นของแข็งอิมิดาโซลและโลหะเร่งปฏิกิริยาเฟอร์โรซีน สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 750-950 องสาเซลเซียส พบว่าท่อนาโนการ์บอนที่สังเคราะห์ได้เป็นท่อนาโน การ์บอนผนังหลายชั้น อยู่รวมกันเป็นมัค เรียงตัวตั้งตรง (Ghosh, Kumar, Maruyama, & Ando, 2010) และมีลักษณะเป็นปล้องไผ่ ในงานวิจัยอื่น ๆ มีการใช้สารตั้งต้นที่เป็นแหล่งกำเนิดการ์บอน และในโตรเจนที่แตกต่างกันดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธี CVD สามารถเลือกใช้สารตั้งต้นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ของแข็ง สารละลาย หรือแก๊ส จึงทำให้ การสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนด้วยวิธี CVD ได้รับความสนใจใช้ในการสังเคราะห์ท่อนาโน การ์บอน (Nxumalo & Coville, 2010)

แหล่งกำเนิดคาร์บอนและในโตรเจน	คะตะลิสต์	อุณหภูมิ (°C)	N (at %)
Ethanol/toluene/ethylenediamine	Ferrocene	850-950	-
Toluene/aniline, ferrocenyl aniline	Ferrocene,ferrocenylaniline	900	1.5
Triphenylphosphine/benzylamine	Ferrocene	720-840	-
Toluene/hexamethylene diamine, benzylamine, quinoline	Ferrocene	850	-
Pyridine	Fe(CO) ₅	900-1100	-
Benzene/CH ₃ CN	Ferrocene, AgNO ₃	900	-
Ethanol/benzylamine	Ferrocene	950	< 2
Benzylamine	Ferrocene	850	-
Xylene/NH ₃ /pyridine	Ferrocene	800	0-9.7
Thiophene/NiPc	Nickelocene,NiPc	900	-
Fullerene/NH ₃	Ferrocene	1050	> 0.1
Ethylenediamine	Co, Ferrocene	780-1080	18.77- 24.45
4-tert-butylpyridine	Ferrocene	700	1.6-2
Toluene/benzylamine	Ferrocene	800-900	0-2.2
CH ₃ CN/THF	Iron(III) acetylacetonate	850	0-2.2
C ₂ H ₂ /NH ₃	Fe(CO) ₅	750-950	3.1-7.2
Monoethanolamine	Ferrocene	900	6.6
Monoethanolamine	Ferrocene	950	7.8
$C_3H_6N_6$	Ferrocene	900-1000	2.3-11.5
Ethanol/ethylenediamine	Ferrocene	900	1.2
NH ₃ /pyridine	Ferrocene	700-1000	4.8-8.8
FePc/thiophene/NH ₃	FePc	900	< 9.0

ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยในโตรเจนด้วยวิธี CVD

2.2.2 กลไกและทฤษฎีการเกิดของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยในโตรเจน

แนวคิดที่ใช้ในการอธิบายกลไกการเกิดท่อนาโนคาร์บอนที่เป็นที่ยอมรับกันอย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน คือ แนวคิดการเกิดแบบ Vapor-Liquid-Solid (VLS) คือ การที่อะตอม การ์บอน (Vapor) แตกตัวเนื่องจากความร้อนและตกแพร่ลงบนโลหะคะตะลิสต์ (Liquid) รวมตัว เกิดเป็นผลึกโครงสร้างท่อนาโนคาร์บอน (Solid)



ภาพที่ 8 แบบจำลองการเกิดท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวแบบ Vapor-Liquid-Solid (VLS) (Kumar, 2011)

ท่อนาโนคาร์บอนเกิดได้ 2 กรณี ได้แก่ การเกิดแบบ "Base-growth" และ "Tip-growth" กรณีของการเกิดแบบ Base-growth จะเกิดที่ชั้นด้านนอกผิวของท่อนาโนการ์บอน เกิดในกรณีที่อันตรกิริยาระหว่างแผ่นรองรับกับโลหะคะตะลิสต์มีก่าสูง เมื่อโมเลกุลของแก๊สตก แพร่มายังบริเวณบนผิว (surface diffusion) ของโลหะคะตะลิสต์ อะตอมของการ์บอนจะเกิดการ แพร่กระจายตัวบนผิวของโลหะคะตะลิสต์ โมเลกุลจะเคลื่อนตัวมายังด้านข้างรวมตัวเกิดเป็นท่อนา โนการ์บอน (Puretzky, Geohegan, Jesse, & Eres, 2005) และในกรณีของการเกิดแบบ Tip-growth จะเกิดท่อนาโนการ์บอนจากด้านใน ซึ่งเกิดในกรณีที่อันตรกิริยาระหว่างแผ่นรองรับกับ โลหะคะตะลิสต์ที่มีก่าต่ำ เมื่อโมเลกุลของแก๊สตกแพร่ลงบนตัวโลหะคะตะลิสต์ ก็จะแพร่กระจาย ตัวเข้าไปด้านใน (Bulk diffusion) ของโลหะคะตะลิสต์เกิดการสะสมกันของอะตอมการ์บอน กลายเป็นท่อนาโนการ์บอน (Reyes, Grobert, Kamalakaran, Seeger, & Terrones, 2004) ซึ่งในกรณี การเกิดท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยในโตรเจนมีรูปแบบของเกิดที่ไม่ต่างจากท่อนาโนการ์บอนที่ เข้าไปแทรกในระบบบริเวณตำแหน่งอะตอมของการ์บอนเดิม เกิดเป็นท่อนาโนการ์บอนที่เจือ ในโตรเจนขึ้น



ภาพที่ 9 รูปแบบจำลองของการเกิดท่อนาโนคาร์บอน (a) Tip-growth และ (b) Base-growth (Kumar, 2011)

2.2.3 ผลของการเจือท่อนาโนคาร์บอนด้วยในโตรเจนต่อโครงสร้างภายในท่อ 2.2.3.1 การเกิดพันธะของในโตรเจนในท่อนาโนคาร์บอน

การแทรกตัวของอะตอมในโตรเจนในแลตทิชของท่อนาโนคาร์บอนสามารถเกิด ใค้หลายรูปแบบ โดยพันธะที่สามารถมีโอกาสเกิดมากที่สุดมี 3 พันธะ ประกอบด้วย pyridine-like N, pyrrole-like N และ graphitic/substitution (Xu, Li, Gui, Jia, Zhu, & Wu, 2010) งานวิจัยของ Ayala et al. (2010). ใค้อธิบายถึงผลของการที่อะตอมในโตรเจนแทรกตัวลงบนผนังท่อนาโน การ์บอน ทำให้เกิดความบกพร่องบริเวณโครงสร้างผนังท่อนาโนคาร์บอน เนื่องจากอะตอม ในโตรเจนเข้าไปจับตัวกับอะตอมของการ์บอน ดังในรูปที่ 17 การจับตัวกันระหว่างพันธะภายใน ท่อนาโนคาร์บอนในรูปของ C-C แบบ sp² เมื่อถูกเจือด้วยอะตอมไนโตรเจน พันธะภายในท่อจะมี การจับตัวของ C-N แบบ sp และ sp³ (Ibrahim, Khavrus, Leonhardt, Rümmeli, & Büchner, 2010) ส่งผลทำให้ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจนมีลักษณะโค้งงอมากขึ้น เนื่องจากการจับตัว กันของพันธะแต่ละบริเวณความยาวของแต่ละสายพันธะจะสั้นยาวไม่เท่ากันจึงทำให้ท่อเกิดโค้งงอ (Xu, Li, Gui, Jia, Zhu, & Wu, 2010)



ภาพที่ 10 ชนิดพันธะที่เป็นไปได้ที่เกิดบนระนาบแกรไฟต์การ์บอน (a) pyridine-like N,

(b) pyrrole-like N, (c) substitutional N, (d) nitrile -C≡N, (e) amine - NH2,
(f) single N pyridinic vacancy, (g) triple N pyridinic vacancy, ແລະ (h) interstitial N (Ewels & Glerup, 2005)



ภาพที่ 11 แสดงชนิดพันธะกับค่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมการ์บอนจับกับอะตอม ในโตรเจน (Biddinger, Deak, & Ozkan, 2009)



ภาพที่ 12 ลักษณะการแทรกตัวของอะตอมในโตรเจนบริเวณผนังท่อนาโนการ์บอนผนังชั้นเดียว (Ayala, Arenal, Rummeli, Rubio, & Pichler, 2010)

 2.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแบบปล้องใผ่ (Bamboo structure) โดยทั่วไปท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยไนโตรเจนมีลักษณะเค่นของโครงสร้างคือ การเกิดโครงสร้างภายในแบบปล้องไผ่ ซึ่งในกระบวนการเกิดเป็นท่อนาโนคาร์บอนแบบเดิมนั้น ลักษณะท่อนาโนคาร์บอนที่ไม่ถูกเจือจะมีลักษณะเป็นท่อกลวง และเมื่อมีการเจือด้วยอะตอมของ ในโตรเจน อะตอมเกิดการแทรกตัวในท่อและเกิดเป็นปล้องขึ้นดังในภาพที่ 13 แต่การเกิด โครงสร้างแบบปล้องไผ่สามารถเกิดทั้งในกรณีของการเจือและไม่เจือไนโตรเจนขึ้นอยู่กับโลหะ คะตะลิสต์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ (Kudashov, Okotrub, Bulusheva, Danilovich, & Abrosimov,
 2004) ถ้าหากพิจารณาการเกิดโครงสร้างแบบปล้องไผ่กับปริมาณของในโตรเจนที่มีอยู่ในท่อนาโน คาร์บอน ปริมาณการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนส่งผลให้ปล้องของท่อนาโนคาร์บอนแคบลง ดังแสดง ในภาพที่ 14 และระยะห่างของปล้องจะห่างมากขึ้นเมื่อมีปริมาณอะตอมไนโตรเจนลดลง รวมทั้ง เงื่อนไขการสังเคราะห์ที่เพิ่มอุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระยะห่างระหว่างปล้องมีค่า เพิ่มขึ้นเช่นกัน (Yadav, Dobal, Shripathi, Katiyar, & Srivastava, 2009)



ภาพที่ 13 การจำลองการเข้าไปแทรกตัวในปล้องไผ่ของอะตอมในโตรเจน (Xu, Li, Gui, Jia, Zhu, & Wu, 2010)



รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ของปริมาณในโตรเจนกับระยะห่างระหว่างปล้องใผ่ เมื่อปริมาณ ในโตรเจนในท่อนาโนการ์บอนเพิ่มขึ้นระยะห่างระหว่างปล้องจะลดลง (Xu, Li, Gui, Jia, Zhu, & Wu, 2010)

2.3 การปลดปล่อยอิเล็กตรอน

ปัจจุบันแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนมักใช้กลไกการกระตุ้นให้มีการปลดปล่อยอิเล็กตรอน จากแหล่งกำเนิดในหลายรูปแบบ ทั้งแบบให้ความร้อนและแบบจ่ายสนามไฟฟ้า โดยกลไกการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนในแต่ละรูปแบบอาศัยกลไกทางกลศาสตร์ควอนตัม คืออิเล็กตรอนของ แหล่งกำเนิดถูกกระตุ้นจากพลังงานภายนอก อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณใกล้ระดับพลังงานเฟอร์มิ (Fermi level) เมื่อได้รับพลังงานทำให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดทะลุผ่านกำแพงศักย์ (tunneling) สู่ ระดับสุญญากาศเป็นอิเล็กตรอนอิสระ สำหรับกระบวนการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของ โลหะมีดังนี้

1. การปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อน (Thermionic emission)

ปรากฏการณ์ซึ่งอิเล็กตรอนถูกปลดปล่อยออกจากผิวของวัสคุเนื่องจากผลของอุณหภูมิ ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (./) คำนวณได้จากสมการริชาร์ดสัน (Richardson equation) (Liang & Ang, 2015) โดยที่

$$J = AT^2 \exp(-\frac{\phi}{kT}) \tag{5}$$

เมื่อ

- **J** คือ ความหนาแน่นของกระแส [A/ cm²]
- $oldsymbol{\phi}$ คือ ค่าฟังก์ชันงาน (work function) [eV]
- A คือ ค่าคงที่ Richardson โดย $A = \frac{4\pi \mathrm{em}k^2}{h^3} = 1.2 \times 10^6 A/m^2 K^2$
- T คือ อุณหภูมิของตัวปลดปล่อย [K]
- k คือ ค่าคงที่ของ Boltzmann 1.371x10⁻²³ J/K



ภาพที่ 15 รูปแบบไคอะแกรมของการปลคปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากความร้อน

2. การปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้า (Field emission)

ปรากฏการณ์ซึ่งอิเล็กตรอนถูกปลอดปล่อยออกจากผิวของวัสดุเนื่องมาจากการจ่าย สนามไฟฟ้า เพื่อให้อิเล็กตรอนกระ โดดข้ามผ่านความสูงของกำแพงศักย์ ซึ่งความหนาแน่นของ กระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ตามสมการของฟาวเลอร์-นอร์ดเฮียม (Fowler-Nordheim: F-N) (Fowler & Nordheim, 1928)

$$J = AE^2/\phi \cdot \exp(-B\phi^{3/2}/\beta E)$$
(6)

เมื่อ \boldsymbol{J} คือ ความหนาแน่นของกระแส $[\mathrm{A/\,cm}^2]$

- ϕ คือ ค่าฟังก์ชันงาน (work function) [eV]
- E คือ สนามไฟฟ้า (V/m)
- **A** คือ ค่าคงที่เท่ากับ 1.54×10^{-6} A•eV
- **B** คือ ค่าคงที่เท่ากับ $6.83 \times 10^9 \text{ eV}^{-3/2} \text{Vm}^{-1}$
- $\boldsymbol{\beta}$ คือ field enhancement factor



ภาพที่ 16 รูปแบบไคอะแกรมของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนเนื่องจากสนามไฟฟ้า

2.4 ค่าฟังก์ชันงาน (work function)

ในปี ค.ศ.1887 เฮิร์ตได้สังเกตเห็นว่าเมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงตก กระทบผิวโลหะ อนุภาคอิเล็กตรอนสามารถหลุดออกมาจากผิวโลหะ ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งแสง และไฟฟ้า

ต่อมาในปี ค.ศ.1898 ทอมสันได้วัดอัตราส่วนระหว่างประจุไฟฟ้าต่อมวลของอนุภาคที่ หลุดออกมาจากโลหะนั้น และพบว่ามีค่าเดียวกับอิเล็กตรอนที่หลุดจากแคโทด จึงเชื่อว่าอนุภาคนั้น เป็นอิเล็กตรอน และเรียกอิเล็กตรอนนั้นว่า โฟโตอิเล็กตรอน (photoelectron)

ใอน์สไตน์อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โดยอาศัยสมมติฐานของพลังค์ แสงเป็น ก้อนพลังงานที่เรียกว่า ควอนตัมของพลังงาน แต่ไอน์สไตน์เรียกว่า โฟตอน (photon) สำหรับแสงที่ มีความถี่ f แต่ละ โฟตอนจะมีพลังงาน hf เมื่อโฟตอนตกกระทบผิวโลหะจะถ่ายโอนพลังงาน hf ทั้งหมดให้กับอิเล็กตรอนของโลหะ โดย 1 โฟตอน จะถ่ายโอนพลังงานให้กับอิเล็กตรอน 1 ตัว แต่ การที่อิเล็กตรอนสมารถหลุดจากผิวโลหะได้ อิเล็กตรอนต้องเสียพลังงานไปปริมาณหนึ่งเท่ากับ พลังงานที่ใช้ในการยึดอิเล็กตรอนไว้ พลังงานนี้เรียกว่า ฟังก์ชันงาน (work function) แทนด้วย สัญลักษณ์ ϕ ซึ่งมีปริมาณที่ต่างกันตามชนิดของโลหะ ดังนั้น พลังงานจลน์สูงสุดของอิเล็กตรอน กำนวนได้จากสมการ

$$E_{K_{\mathfrak{g}^{\mathsf{NAP}}}} = hf - \emptyset \tag{7}$$

ในทำนองเดียวกันกับปรากฎการณ์ โฟโตอิเล็กทริก ปรากฎการณ์ปลดปล่อยอิเล็กตรอน เนื่องจากความร้อน (Thermionic emission) และการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้า (Field emission) เมื่อ โลหะ ได้รับความร้อน อิเล็กตรอนในโลหะบางตัวจะ ได้รับพลังงานสูงกว่า ฟังก์ชันงานในโลหะและทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโลหะ ได้ โดยปกติอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าใน โลหะนั้นอยู่ในแถบนำไฟฟ้า (conduction band) อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ในแถบนำ ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ โดยอิเล็กตรอนไม่หลุดออกจากโลหะที่อุณหภูมิห้อง นอกจากได้รับพลังงาน เข้าไปกระตุ้น ทั้งนี้เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างนิวเกลียสซึ่งมีประจุบวกกับอิเล็กตรอนภายในโลหะ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนกับว่าอิเล็กตรอนอยู่ภายในโลหะโดยมีกำแพงศักย์ (potential barrier) กั้นอยู่ ที่ผิวโลหะ ระดับพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือระดับเฟอร์มิ (fermi level) ซึ่งพลังงานที่น้อยที่สุด ที่สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะหรือค่าฟังก์ชันงาน (work function) ขึ้นกับชนิด ของโลหะ อิเล็กตรอนที่อยู่ต่ำกว่าระดับเฟอร์มิจะต้องการพลังงานมากกว่าค่าฟังก์ชันงาน (work function) ในแต่ละโลหะมีค่าฟังก์ชันงานคงที่ดังแสดงในตารางที่ 2

1A	ILA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB		VIII	_	IB	ΠВ	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
3 Li 2.9	4 Be 4,98							-				5 B 4.45	6 C 5,0		_	
11 Na 2,75	12 Mg 3.66											13 Al 4,28	14 Si 4.85	15 P	16 S	
19 К 2.30	20 Ca 2, 87	21 Sc 3.5	22 Ti 4.33	23 V 4.3	24 Cr 4.5	25 Mn 4,1	26 Fe 4.5	27 Co 5.0	28 Ni 5, 15	29 Cu 4.65	30 Zn 4,33	31 Ga 4.2	32 Ge 5.0	33 As 3.75	34 Se 5 . 9	Br
37 Rb 2,16	38 Sr 2, 59	39 Y 3.1	40 Zr 4.05	41 Nb 4,3	42 Mo 4.6	43 Te	44 Ru 4.71	45 Rh 4,98	46 Pd 5,12	47 Ag 4.26	48 Cd 4,22	49 In 4.12	50 Sn 4.42	51 Sb 4.55	52 Te 4.95	I
55 Cs 2.14	56 Ba 2.7	57 La 3.5	72 Hf 3.9	73 Ta 4, 25	74 W 4.55	75 Re 4,96	76 Os 4.83	77 Ir 5,27	78 Pt 5,65	79 Au 5.1	80 Hg 4.49	81 Tl 3.84	82 Pb 4,25	83 Bi 4.22	84 Po	At
87 Fr	88 Ra	89 Ac	90 Th 3.4	91 Pa ••••	92 U 3,63											
			58 Ce 2.9	59 Pr	60 Nd 3,2	61 Pm	62 Sm 2,7	63 Eu 2.5	64 Gd 3, 1	65 Tb 3.0	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu 3, 3
			90 Th 3.4	91 Pa	92 U 3.63	93 Np	•••	•••	•••	•••	• • •		•••		•••	• • •

ตารางที่ 2 แสดงค่าฟังก์ชันงาน (work function) ในหน่วย eV ของธาตุต่าง ๆ (Michaelson, 1977)

2.5 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนการ์บอนได้รับความสนใจอย่างมากในการศึกษาถึงรายละเอียดของสมบัติการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอน เนื่องจากท่อนาโนการ์บอนสามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ดี เมื่อถูก กระตุ้นด้วยพลังงานที่ต่ำและให้ก่าความหนาแน่นกระแสที่สูง ทั้งนี้พฤติกรรมการปลดปล่อย อิเล็กตรอนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและพันธะทางเคมีของท่อนาโนการ์บอน ในการประยุกต์ใช้ท่อ นาโนการ์บอนสำหรับเป็นตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอนจึงต้องกำนึงถึงตัวแปรหลายชนิด เช่น ประเภท ของท่อนาโนการ์บอนที่นำมาใช้เป็นแบบผนังชั้นเดียวหรือผนังหลายชั้น ลักษณะปลายท่อ ก่าความ หนาแน่นของท่อบนวัสดุรองรับ การจัดเรียงตัวของท่อนาโนการ์บอนบนวัสดุรองรับ และผลของ การเจืออะตอมธาตุอื่นเข้าไปในท่อนาโนการ์บอน เป็นต้น โดยมีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว แปรที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนดังนี้

2.5.1 ลักษณะปลายท่อ (ท่อปลายปิดและท่อปลายเปิด)

การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนที่มีลักษณะปลายท่อ ที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ Kang and Zhou (2004) ได้ศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อ นาโนคาร์บอนภายใต้เงื่อนไขของท่อปลายเปิดกับท่อปลายปิด โดยท่อนาโนคาร์บอนสังเคราะห์ที่ อุณหภูมิ 550-750 องศาเซลเซียส เมื่อทำการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอน พบว่าการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของท่อนาโนคาร์บอนปลายปิดจะใช้สนามไฟฟ้ากระตุ้นให้ อิเล็กตรอนหลุดน้อยกว่าท่อปลายเปิด เนื่องจากท่อปลายเปิด อิเล็กตรอนที่หลุดจะมาจากผนังชั้นใน ของท่อ ส่วนท่อปลายปิดอิเล็กตรอนหลุดนั้นจะมาจากผนังชั้นนอกที่ปลายท่อ ทำให้โอกาสที่ อิเล็กตรอนของท่อปลายปิดจึงหลุดได้ง่ายกว่าท่อปลายเปิด (Kang & Suh, 2004)



ภาพที่ 17 แสดงภาพ SEM ของท่อนาโนคาร์บอนปลายปิดในรูป a และ c ท่อปลายเปิดในรูป b และ d ความยาวของท่อ 110±2 nm (Kang & Suh, 2004)



ภาพที่ 18 ค่าความหนาแน่นกระแสภายใต้สนามไฟฟ้าที่วัดได้ของตัวอย่าง (a) ท่อปลายปิด และ (b) ท่อปลายเปิด สี่เหลี่ยมเล็กคือค่าที่ได้จากสมการ Fowler-Nordheim (Kang & Suh, 2004)

2.5.2 ประเภทของท่อและการเรียงตัวบนวัสดุรองรับ

รายงานเกี่ยวกับการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนภายใต้เงื่อนไขของ การเรียงตัวของท่อนาโนคาร์บอนที่แตกต่างกัน งานวิจัยของ Cheng and Zhou (2003) ได้ทำการศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนภายใต้เงื่อนไขของประเภท ของท่อนาโนคาร์บอน พบว่าที่ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเท่ากัน ท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้น เดียวใช้สนามไฟฟ้ากระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดน้อยกว่าท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้น และเมื่อ เปรียบเทียบระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นที่เรียงตัวเป็นระเบียบในแนวตั้งตรงและแบบ เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ท่อนาโนคาร์บอนที่เรียงตัวเป็นระเบียบในแนวตั้งตรงใช้สนามไฟฟ้ากระตุ้น ให้อิเล็กตรอนหลุดน้อยกว่าท่อนาโนคาร์บอนที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (Cheng & Zhou, 2003)



ภาพที่ 19 ค่าความหนาแน่นกระแสภายใต้สนามไฟฟ้าที่วัดได้ของตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวปลดปล่อยใน รูปแบบต่าง ๆ จากงานวิจัยของ Cheng and Zhou (Cheng & Zhou, 2003)

2.5.3 การเจือในโตรเจนในท่อนาโนการ์บอนและตัวแปรอื่น ๆ

ในงานวิจัยของ Wang et al. (2002) ได้ศึกษาผลการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของ ้ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจนมีค่าสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ต่ำ กว่าของท่อนาโนการ์บอนที่ไม่ถกเจือ โดยมีก่า สนามไฟฟ้าที่เริ่มปล่อยอิเล็กตรอนที่ 1.5 V/um และ ี้มีค่าความหนาแน่นกระแสที่ 80 แA/cm² เปรียบเทียบกับท่อนาโนคาร์บอนที่ไม่ถกเจือที่ค่าความ หนาแน่นกระแสที่ 80 μA/cm² ต้องใช้สนามไฟฟ้าในการกระตุ้นให้อิเล็กตรอนเริ่มหลุดที่ค่า 2.6 V/μm (Wang, Liu, Zhu, Zhang, Yao, & Zhang, 2002) จะเห็นได้ว่าท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วย ้ในโตรเจนปลคปล่อยอิเล็กตรอนได้ดีกว่าในกรณีที่ไม่ถูกเจือ แต่ในงานวิจัยของ Bonard และ ้คณะวิจัย ได้อธิบายถึงผลการเปรียบเทียบของการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโน ้ การ์บอนที่ถูกเจือและ ไม่ถูกเจือด้วย ใน โตรเจนด้วยเงื่อน ใขขนาดรัศมีท่อ พบว่าท่อนาโนการ์บอนที่ ้ไม่ถูกเจือที่มีรัศมีของท่อใหญ่กว่าท่อที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน ท่อนาโนการ์บอนที่ไม่ถูกเจือจะ ้ปลดปล่อยอิเล็กตรอนมีก่าใกล้เกียงและปลดปล่อยได้ดีกว่าท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือในบาง ้ตัวอย่าง ผลมาจากรัศมีของท่อที่ไม่ถูกเจือมีขนาดใหญ่กว่าทำให้มีจำนวนอิเล็กตรอนที่ผนังท่อ ้มากกว่า โดยบางอิเล็กตรอนในผนังท่ออาจจับตัวด้วยพันธะที่ไม่แข็งแรงเท่ากับท่อที่ถูกเจือ ทำให้ ้โอกาสที่อิเล็กตรอนหลุดมีโอกาสมากกว่าท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือ (Bonard, Kurt, & Klink, 2001) และในงานวิจัยของ Shah et al. (2009) ได้อธิบายเกี่ยวกับผลของ โลหะคะตะลิสต์ที่มีผลต่อ ึกลไกการปลคปล่อยสนามอิเล็กตรอน โคยในงานวิจัยใช้เหล็กเป็นกะตะลิสต์ในการสังเคราะห์ท่อ ้นาโนการ์บอน ในการทดลองพบว่า เมื่อง่ายก่าศักย์ไฟฟ้าให้ท่อนาโนการ์บอนอิเล็กตรอนที่หลุด ้ออกมาช่วงแรกคืออิเล็กตรอนที่หลุดจากท่อนาโนการ์บอนโคยตรง เนื่องจากท่อนาโนการ์บอนมี

กำแพงพลังงานศักย์ที่กักเก็บอิเล็กตรอนน้อยกว่าของโลหะคะตะลิสต์ แต่เมื่อจ่ายสนามไฟฟ้าให้ ตัวอย่างเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้พลังงานกระตุ้นต่ออิเล็กตรอนของตัวโลหะคะตะลิสต์มีก่าสูงมากพอที่ สามารถเกลื่อนผ่านกำแพงพลังงานศักย์ออกมาได้ ซึ่งในแต่ละวัสดุจะมีก่ากำแพงพลังงานศักย์ที่ แตกต่างกัน

2.6 การประยุกต์ใช้วัสดุสำหรับเป็นแหล่งปลดปล่อยอิเล็กตรอน

จากผลของการศึกษาสมบัติของท่อนาโนการ์บอน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลาย ด้าน เช่น เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สต่างๆ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโครเจน ตัวช่วยในการ เกิดปฏิกิริยา รวมทั้งตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอน เป็นค้น ปัจจุบันงานวิจัยสำหรับทดสอบหาวัสอุที่ เหมาะสมสำหรับนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนมีการเลือกใช้วัสอุที่หลากหลาย จำพวก ในการเลือกใช้ต้องกำนึงประสิทธิภาพของการปลดปล่อยอิเล็กตรอน รากาประหยัด และมี อายุการใช้งานที่นาน ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มวัสดุประเภทท่อนาโนการ์บอนให้ผลการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ที่สูง ใช้สนามไฟฟ้าในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ต่ำ สังเคราะห์ง่าย ดังนั้นท่อนาโนการ์บอนจึงถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนและ เสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น การเจืออะตอมธาตุอื่น ๆ เข้าไป การสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอนให้เกิด พันธะกับวัสดุชนิดอื่น เป็นด้น เพื่อเข้าไปลดฟังก์ชันงานที่กักเก็บอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนหลุด ได้ง่ายและการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่มีเสลียรภาพมากขึ้น



ภาพที่ 20 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามของวัสดุต่าง ๆ (Cole, Nakamoto, & Milne, 2015)

2.7 การวัดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยวิธีสองโพรบและสภาพต้านทานโดยวิธีสี่โพรบ

วิธีสองโพรบ (Two points probe) คือการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าเข้า ไปยัง โพรบที่ 1 และเมื่อกระแสไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าไหลไปที่โพรบที่ 2 ค่าที่ได้จากการ วัดสามารถกำนวณหาก่าต้านทานไฟฟ้าที่ผิววัสดุระหว่างสองโพรบได้จากสมการ

$$R_{total} = Voltage(V)/Current(I) = 2R_c + 2R_{sp} + R_s$$
(8)

R_{sp} คือ ความต้านทานไฟฟ้ากระจายหรือความต้านทานไฟฟ้าที่เกิค โดยการไหลของ กระแสในพื้นผิวตัวอย่าง

 $\mathbf{R}_{\mbox{\tiny k}}$ คือ ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวเฉพาะวัสดุ

วิธีสี่โพรบ (Four points probe) หรือ เข็ม 4 จุด สามารถวัดได้ทุกขนาดของแท่งสารไม่ว่า จะมีขนาดรูปร่างอย่างไร สามารถวัดบนแผ่นผลึก ที่บริเวณผิวหน้าของแผ่นผลึกได้ โดยการวัดจะ ใช้เข็ม 4 เข็ม และในการวัดฟิล์มท่อนาโนคาร์บอน อาจจะใช้เข็มที่ปลายไม่แหลมที่มีสปริงช่วยใน การกด เพื่อลดปัญหาปลายเข็มที่แหลมเกินไปกดทำให้ชั้นฟิล์มทะลุ โดยเข็ม A B C และ D อยู่ห่าง กันระยะ S เท่าๆกัน ในการวัดจะเริ่มจากการปล่อยขนาดกระแสที่คงที่เข้าไปบริเวณเข็มด้านนอกสุด คือเข็ม A และ D ทำ ให้มีกระแสไหลจากขั้ว A ผ่านเนื้อสารกึ่งตัวนำ ไปยังเข็ม D เกิดแรงดันตก คร่อมบริเวณเนื้อสาร ทำการวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้ว B และ C นำ ค่ากระแสคงที่ I และแรงดัน V ที่วัดได้มากำนวณหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าได้จากสมการ

แม้ว่าวิธีสองโพรบสามารถใช้คำนวณความต้านทานไฟฟ้าที่ผิววัสคุได้ แต่วิธีสี่โพรบจะ มีความถูกต้องสูงกว่า เนื่องจากวิธีสี่โพรบจะใช้โพรบแยกกันระหว่างโพรบที่จ่ายและโพรบที่ใช้วัด สามารถลดสัญญาณรบกวนที่มาจากแหล่งจ่ายได้ ดังนั้นสามารถจำกัดความต้านทานไฟฟ้าที่ปนเข้า มาของ Rc และ Rsp ที่ได้จากการวัดโดยใช้วิธีสองโพรบ

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 2\pi S(V/I) \tag{9}$$

เมื่อ S คือ ระยะห่างระหว่างโพรบ, V คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และ I คือ ค่ากระแสไฟฟ้า



ภาพที่ 21 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าโดยวิธีสี่โพรบ (Li, Wang, & Ba, 2012)

ในการวิเคราะห์ทำได้โดยพิจารณาว่า ขนาดของชิ้นงาน นี้มีขนาดใหญ่และมีความหนา (d) มากกว่าระยะห่างระหว่างเข็ม (s) หรือ d >>s กระแสจากขั้ว A จึงสามารถผ่านออกไปที่ขั้ว D ได้ ดังในรูปที่ 2.28

ในกรณีของการวัดชิ้นงานประเภทสารกึ่งตัวนำ ที่มีความหนาน้อย ๆ หรือ บางมาก ๆ ความหนาของชั้นสาร มีค่าน้อยกว่าระยะห่างระหว่างเข็ม หรือ x << s ต้องคำนวณหาสภาพ ต้านทานไฟฟ้าด้วย สมการสภาพต้านทานของแผ่น หรือ Sheet resistivity ดังสมการ

·---

$$\rho = 4.532 \left(\frac{\nu}{I}\right) \quad \Omega/cm \tag{10}$$



ภาพที่ 22 แสดง โครงสร้างของชั้นสารตัวอย่างชั้นบาง ๆ ที่อยู่บนแผ่นผลึกฐานรอง

บทที่ 3

ວີ້ 5ີ່ ຄາງດຳເນີນດາງວີຈັຍ

3.1 ระบบ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมท่อนาโนคาร์บอน

ระบบการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน แสดงดังแผนภาพในภาพที่ 23 และวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์มีดังนี้

- 3.1.1 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน
 - 3.3.1.1 ท่อควอตซ์ (Quartz tube)
 - 3.3.1.2 ระบบให้ความร้อน
 - 3.3.1.3 เกจวัดความดัน
 - 3.3.1.4 ภาชนะควอทซ์ (Quartz boat)
 - 3.3.1.5 แผ่นซิลิกอนสำหรับใช้เป็นวัสดุรองรับ (Si)
 - 3.3.1.6 อุปกรณ์ควบคุมการใหลของแก๊ส
 - 3.3.1.7 แก๊สอาร์กอน (Ar)
 - 3.3.1.8 อิมิคาโซล ($C_3H_4N_2$) ความบริสุทธิ์ 99%
 - 3.3.1.9 เฟอร์โรซีน (Fe(C $_{\rm s} {
 m H}_{\rm s})_2$) ความบริสุทธิ์ 98%



ภาพที่ 23 แสดงรูประบบ CVD ที่ใช้ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

- 3.1.2 เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบธาตุของท่อนาโนคาร์บอน
 - 3.1.2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค (SEM)
 - 3.1.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
 - 3.1.2.3 เครื่องรามานสเปกโทรสโกปี (Raman spectroscopy)
 - 3.1.2.4 เครื่องเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (XPS)
 - 3.1.2.5 เครื่องอัลตราไวโอเลตโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (UPS)

3.2 วิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

เงื่อนไขและขั้นตอนการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เจือในโตรเจน

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน โดยการใช้เฟอร์โรซีนผสม อิมิดาโซล สำหรับเงื่อนไขในการสังเคราะห์โดยใช้สารตั้งต้น โดยอิมิดาโซลจะเป็นสารตั้งต้นของ ทั้งแหล่งการ์บอนและในโตรเจน โดยเฟอร์โรซีนเป็นทั้งแหล่งกำเนิดของโลหะคะตะลิสต์และ การ์บอน เงื่อนไขของการสังเคราะห์เป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เงื่อนใขการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

	เฟอร์ โรซีน	อิมิคาโซล		
	1.0 กรัม	0 กรัม		
ลโรงเวอเสวรร้างขึ้น	1.0 กรัม	0.5 กรัม		
៣១។ ពោ ប	1.0 กรัม	1.0 กรัม		
	1.0 กรัม	1.5 กรัม		
	1.0 กรัม	2.0 กรัม		
อุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์	900 องศ	าเซลเซียส		
เวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์	30 นาที			
อัตราการไหลแก๊สอาร์กอน	500	sccm		
วัสคุรองรับ	ซิลิเ	กอน		

ขั้นตอนในการสังเคราะห์ท่อนาโนการ์บอน

นำซิลิกอนที่ใช้เป็นวัสดุรองรับวางบริเวณกึ่งกลางของท่อควอทซ์ ทำการผสมผง เฟอร์ โรซีนกับอิมิดาโซลในภาชนะกวอตซ์ จากนั้นนำไปวางในท่อควอตซ์ใกล้วัสดุรองรับ โดยให้มี ระยะห่างกันประมาณ 15 เซนติเมตร เลื่อนระบบเตากวามร้อนไปยังบริเวณที่วางซิลิกอน หลังจาก นั้นเปิดระบบเตากวามร้อน และปล่อยอาร์กอนเข้าสู่ระบบด้วยอัตราการไหล 500 sccm เพื่อไล่ อากาศในระบบออกไป เมื่ออุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส ทำการเลื่อนเตากวามร้อนให้อยู่บริเวณที่ วางภาชนะกวอตซ์ที่มีเฟอร์ โรซีนและอิมิดาโซลเป็นเวลา 30 นาที เมื่อกรบ 30 นาที หยุดให้กวาม ร้อน แต่ยังคงปล่อยอาร์กอนเข้าสู่ระบบ สุดท้ายเมื่อระบบเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้อง นำวัสดุรองรับ ออกจากระบบ

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์สมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน

นำฟิล์มบางท่อนาโนการ์บอนที่สังเคราะห์ได้ในเงื่อนไขต่าง ๆ ตัดให้ได้ขนาด 0.25 cm² วางบนแท่งทองแดงที่เป็นขั้วแคโทด จากนั้นนำการ์บอนเทปติดบนแท่งทองแดงขั้ว แคโทดและแอโนด แล้วติดกระจกสไลด์กับการ์บอนเทปเพื่อกำหนดก่าระยะห่างระหว่างขั้วที่ 300 µm วางอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดสอบใน chamber ทำการต่อลวดทองแดงที่เชื่อมต่อในระบบ chamber เข้ากับขั้วทั้งสอง เชื่อมสายไฟฟ้าจากระบบที่ต่อกับ chamber เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า แรงดันสูงและเครื่องมือวัด Multimeter Fluke โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้าถูก กวบกุมและเก็บข้อมูลด้วยกอมพิวเตอร์ ทำการดูดอากาศใน chamber จนความดันประมาณ 3x10⁻⁶ mbar ทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าและวัดกระแสไฟฟ้าจากการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของ ท่อนาโนการ์บอน



ภาพที่ 24 แผนภาพแสดงการทดสอบสมบัติการปลดปล่อยสนามอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน

3.4 ขั้นตอนการเตรียมและวัดความต้านทานทางใฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอน

- เตรียมสารละลายท่อนาโนการ์บอน โดยการขูดผงท่อนาโนการ์บอนออกจากแผ่นวัสดุ รองรับซิลิกอน จากนั้นนำท่อนาโนการ์บอนจำนวน 5 มิลลิกรัมไปกระจายตัวในตัวทำ ละลาย Ethanol ปริมาตร 100 มิลลิลิตรและทำให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันด้วย เกรื่องอัลตราโซนิกส์ โดยทำการสั่นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- หยุดสารละลายที่เตรียมได้ลงบนแผ่น Printed circuit board (PCB) จำนวน 5 ใมโครลิตร นำไปอบเพื่อกำจัดตัวทำละลายที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
- นำแผ่น PCB ที่เตรียมได้ทำการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธี 2 โพรบภายใต้ระบบ ความดันบรรยากาศอาร์กอน ขณะวัดทำการง่ายกระแสไฟฟ้า (I) คงที่ 50.5 mA ไปที่ ขั้วไฟฟ้า
- ทำการวัดค่าความต่างสักย์ไฟฟ้า ซึ่งขณะทำการวัดให้ความร้อนกับแผ่น PCB ที่เตรียม จากอุณหภูมิห้องถึงอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส
- น้ำค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ มาหาค่าความต้านทานไฟฟ้า แล้วน้ำค่าที่ได้มาพล็อตกราฟ ระหว่าง △R กับ อุณหภูมิ (T) ที่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 25 แสดง PCB สำหรับการทดสอบวัดค่าต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอน

ผลการวิจัย

4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของท่อนาโนคาร์บอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน

จากผลการวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของท่อนาโน คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 26(a-e) ประกอบด้วยภาพ (a) N0, (b) N1, (c) N2, (d) N3 และ (e) N4 ตามลำคับ โคยในแต่ละภาพได้แทรกภาพที่มีกำลังขยายสูงเพื่อแสดงรายละเอียด ้ของการเรียงตัวของท่อนาโนการ์บอนที่สังเกราะห์ได้ในแต่ละเงื่อนไขที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จาก ภาพตัดขวาง SEM พบว่าท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้มีการเรียงตัวในแนวตั้งฉากบนวัสดุ รองรับ ภาพที่ 26(a) ตัวอย่างท่อนาโนคาร์บอน N0 ที่ใช้เพียงสารตั้งต้นเฟอร์โรซีนในการสังเคราะห์ ท่อนาโนคาร์บอนที่ได้รูปแบบของการเรียงตัวยังไม่เป็นระเบียบในแนวตั้งฉากมากนักและท่อนาโน ้ การ์บอนที่ได้มีลักษณะ โค้งงอไม่เป็นเส้นตรง โคยมีกวามสูงของท่ออยู่ที่ 8.22±0.57 μm ในภาพที่ 26(b-e) เมื่อทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสังเคราะห์โดยการเพิ่มปริมาณสารตั้งต้นอิมิดาโซล และใช้สารตั้งต้นเฟอร์โรซีนในปริมาณคงที่เท่าเดิมที่ 1 กรัมในทุกเงื่อนไข พบว่าท่อนาโนคาร์บอน ที่สังเคราะห์ได้ มีลักษณะความเป็นท่อและมีรูปแบบการเรียงตัวในแนวตั้งฉากบนวัสดุรองรับ ซิลิกอนอย่างเป็นระเบียบ ท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้มีแนวโน้มของความสูงเพิ่มขึ้นตามการ เพิ่มปริมาณสารตั้งต้นอิมิดาโซล โดยความสูงของท่อนาโนการ์บอนตัวอย่าง N1, N2, N3 และ N4 อยู่ที่ 12.31±0.40 μm, 15.33±1.28 μm, 24.84±0.53 μm และ 53.40±1.19 μm ตามลำคับ สังเกตได้ว่า ท่อนาโนคาร์บอนที่ตัวอย่าง N4 มีความสูงของท่อที่มากที่สุด สาเหตุดังกล่าวมาจากการเพิ่ม ้อัตราส่วนปริมาณสารตั้งต้นอิมิคาโซล โดยในส่วนประกอบของสารตั้งต้นอิมิคาโซลมี ้ส่วนประกอบของธาตุการ์บอนอยู่ด้วย ส่งผลทำให้ในกระบวนการสังเคราะห์จะมีปริมาณอะตอม ้คาร์บอนที่แตกตัวจากสารตั้งต้นเพิ่มแต่โลหะคะตะลิสต์ยังเท่าเดิม อะตอมของการ์บอนที่แตกตัว ้เพิ่มขึ้นนี้ จะเพิ่มโอกาสที่เข้าไปจับตัวกับโลหะคะตะลิสต์ทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีแนวโน้มความ สูงเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 26 ภาพถ่ายจาก SEM ของตัวอย่าง (a) N0, (b) N1, (c) N2, (d) N3 และ (e) N4 โดยขีดสเกล ของภาพอยู่ที่ 2 ใมโครเมตร

ผลการวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรสน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) แสดงในภาพที่ 27(a-j) พบว่าท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะแบบท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้น โดย ภาพที่ 27(a-b) ด้วอย่าง N0 ที่ใช้เพียงสารตั้งด้นเฟอร์ โรซีนในการสังเคราะห์ ลักษณะของท่อนาโน คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะรูปร่างเป็นแบบทรงกลมกลวง มีผนังท่อหนา ผิวท่อบางบริเวณมี กลุ่มของอะมอร์ฟัสคาร์บอนเกาะอยู่ โครงสร้างภายในท่อพบจุคสีตำแสดงถึงคะตะลิสต์ที่เจือปนอยู่ ค่อนข้างมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่วัดได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.45±0.57 nm และความหนา ของผนังอยู่ที่ 10.15±1.82 nm ในภาพที่ 27(c-j) ตัวอย่าง N1-N4 เป็นท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วย อะตอมไนโตรเจน แสดงลักษณะโครงสร้างภายในที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายปล้องไผ่ (Bamboo-like structure) มีผนังของท่อที่บางและที่ผิวของผนังท่อมีความขรุขระ โดยตัวอย่าง N1, N2, N3 และ N4 มีความหนาของผนังอยู่ที่ 7.61±0.93 nm , 6.04±0.76 nm, 3.82±0.32 nm และ 3.23±0.54 nm ตามลำคับ โดยโครงสร้างกล้ายปล้องไผ่ของท่อนาโนการ์บอนที่เกิดขึ้น น้น สาเหตุเนื่องจากอะตอมของ ในโตรเจนเข้าไปแทรกตัวภายในท่อ อีกทั้งที่ผนังท่อมีความขรุขระเกิดขึ้นนั้น สาเหตุมาจาก อิเล็กตรอนของอะตอมไนโตรเจนที่เข้าไปแทรกตัวภายในท่อมีความขรุขระเกิดขึ้นนั้น สาเหตุมาจาก อิเล็กตรอนของอะตอมไนโตรเจนที่เข้าไปแทรกตัวภายในท่อมีความขรุงระเกิดขึ้นนั้น สาเหตุมาจาก อิเล็กตรอนของอะตอมไนโตรเจนที่เข้าไปแทรกตัวภายในท่อมีความจรุงระเกิดขึ้นนั้น สาเหตุมาจาก อิเล็กตรอนจองอะตอมไนโตรเจนที่เข้าใปเตรงจุมแต่อร์บิทัลที่ค่างกัน อิเล็กตรอนที่ผสมกันนี้จะ เกิดเป็นออร์บิทัลใหม่ โดยเกิดไฮบริไดเซชันแบบ sp. sp² และ sp³ ทำให้ความยาวของพันระ ระหว่างอะตอมและมุมระหว่างออบิทัลมีความแตกต่างกัน เมื่อเกิดเป็นท่อนาโนคาร์บอน จึงทำให้ ท่อนาโนคาร์บอนเกิดผิวที่มีความจรุจระ โดยท่อนาโนคาร์บอนที่ไม่ถูกเจือด้วยในโตรเจน การจับ ตัวของอะตอมในโครงสร้างภายในท่อผนังท่อมีรูปไฮบริไดเซซันของการ์บอนแบบ sp² เพียง รูปแบบเดียวผนังท่อจึงมีผิวเรียบกว่าท่อที่ถูกเจือด้วยในโตรเจน นอกจากนี้จุดสีดำในภาพที่แสดงถึง กะตะลิสต์ที่ติดเจือปนอยู่ก็ลดน้อยลงไปด้วย เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารอิมิดาโซล กระบวนการ สังเคราะห์จะมีปริมาณอะตอมการ์บอนที่แตกตัวจากสารตั้งต้นเพิ่ม อะตอมของการ์บอนที่แตกตัว เพิ่มขึ้นนี้มีมากพอที่จะเข้าที่เข้าไปจับตัวกับโลหะกะตะลิสต์และเกิดเป็นท่อนาโนการ์บอนที่สังเคราะห์ ส่งผลทำให้โลหะที่เจือปนและตกก้างลดน้อยลง โดยรายละเอียดของท่อนาโนการ์บอนที่สังเคราะห์ ได้แสดงในตารางที่ 4

ตัวอย่าง	ความสูง (µm)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (nm)	ความหนาของผนังท่อ (nm)
NO	8.22 ± 0.57	32.45 ± 4.01	10.15±1.82
N1	12.31 ± 0.40	39.47 ± 3.72	7.61±0.93
N2	15.33 ± 1.28	37.42 ± 12.94	6.04±0.76
N3	21.84 ± 0.53	47.37 ± 10.53	3.82±0.32
N4	53.40 ± 1.19	22.80 ± 3.04	3.23±0.54

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้



ภาพที่ 27 ภาพถ่ายจาก TEM ที่กำลังขยายต่ำและกำลังขยายสูงของตัวอย่าง (a-b) N0, (c-d) N1, (e-f) N2, (g-h) N3 และ (i-j) N4

ผลการวิเคราะห์จากเทคนิคเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (XPS) ของ ้ตัวอย่างท่อนาโนการ์บอนที่พลังยึดเหนี่ยวในช่วง 0-1200 eV เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 28(a) แสดง ้สเปกตรัมของ XPS พบว่าท่อนาโนการ์บอนที่สังเคราะห์ได้ มีองค์ประกอบของธาตุ การ์บอน ้ออกซิเจน ในโตรเจน และเหล็ก เมื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลจากภาพถ่ายจากกล้อง TEM และผลของ XPS สามารถยืนยันได้ว่าลักษณะ โครางสร้างคล้ายปล้องไผ่ของท่อนาโน ้คาร์บอนที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการแทรกตัวของอะตอมของในโตรเจน ซึ่งไม่พบโครงสร้างแบบ ้ปล้องไผ่ในตัวอย่างที่สังเคราะห์ด้วยเงื่อนไขที่ไม่เงือไนโตรเงน ในภาพที่ 28(b-d) แสดงสเปกตรัม XPS พลังงานยึดเหนี่ยวของพันธะของในโตรเจน (N 1s) ในท่อนาโนการ์บอน โดยวิเคราะห์ ฐปแบบโครงสร้างของในโตรเจนที่เกิดขึ้นในท่อนาโนคาร์บอนจากพลังงานยึดเหนี่ยวของพันธะใน แต่ละตัวอย่างได้ดังนี้ ตัวอย่าง N2 โครงสร้างของในโตรเจนที่เกิดในท่อมี 5 รปแบบโครงสร้าง สัมพันธ์กับพลังงานพันธะ คือ Pyridinic nitrogen (398.8 eV), Pyrrolic nitrogen (399.7 eV), Quaternary nitrogen (401.2 eV) Pyridinic oxide (402.3 eV) 1182 Oxygenated nitrogen (403.3 eV) ้ตัวอย่าง N3 โครงสร้างของในโตรเจนที่เกิดในท่อมี 4 รูปแบบโครงสร้างสัมพันธ์กับพลังงานพันธะ กือ Pyridinic nitrogen (398.6 eV), Pyrrolic nitrogen (399.5), Quaternary nitrogen (401.3 eV) และ Pyridinic oxide (402.3 eV) และในตัวอย่าง N4 โครงสร้างของในโตรเจนที่เกิดในท่อมี 2 รูปแบบ โครงสร้างสัมพันธ์กับพลังงานพันธะ คือ Pyridinic nitrogen (399.1 eV) และ Quaternary nitrogen (401.2 eV) ในส่วนของตัวอย่าง N1 ไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบของโครงสร้างได้เนื่องจากปริมาณ ในโตรเจนมีน้อยเกินไป ตัวอย่าง N2-N4 สามารถสรุปเป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์โดยจำนวนอะตอม ของรูปแบบโครงสร้างในโตรเจนคังตางรางที่ 5

ตัวอย่าง	%N โดยจำนวน	รงในงานโอสงสร้าง	เปอร์เซ็นต์โดยจำนวน	ตำแหน่งพีค
N. 100 14	อะตอม	រឺ ៣ពេក សោរយរ <i>ប</i>	อะตอม (at%)	(eV)
N2	2.69	Pyridinic nitrogen	0.56	398.8
		Pyrrolic nitrogen	0.22	399.7
		Quaternary nitrogen	1.19	401.2
		Pyridinic oxide	0.53	402.3
		Oxygenated nitrogen	0.19	403.3

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลปริมาณเปอร์เซ็นต์โดยจำนวนอะตอมของรูปแบบโครงสร้างในโตรเจนของ ตัวอย่าง N2-N4

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตัวอย่าง	%N โดยจำนวน	<u>ราในมามโอสาสร้าง</u>	เปอร์เซ็นต์โดยจำนวน	ตำแหน่งพิค
	อะตอม	วิทแกก เผวงยว เง	อะตอม (at%)	(eV)
N3		Pyridinic nitrogen	0.52	398.6
	2.82	Pyrrolic nitrogen	0.37	399.5
		Oxygenated nitrogen	1.55	401.3
		Pyridinic oxide	0.38	402.3
N4	4.00	Pyridinic nitrogen	2.04	399.1
	4.06	Quaternary nitrogen	2.02	401.2



ภาพที่ 28 XPS องค์ประกอบของธาตุ (a) เป็นการแสดงองค์ประกอบของธาตุในท่อนาโนการ์บอน (b), (c) และ (d) แสดงพลังงานยึดเหนี่ยวพันธะของในโตรเจนในท่อนาโนการ์บอนของ ตัวอย่าง N2 N3 และ N4

้ผลการวิเคราะห์ความไม่สมบูรณ์ของระนาบกราฟีนในโครงสร้างท่อนาโนคาร์บอน ด้วย เทคนิคของรามานสเปกโทรสโกปี พบว่าตัวอย่าง N0, N1, N2, N3 และ N4 ปรากฏ D-peak ที่ 1352, 1348, 1350, 1353 และ 1350 และ G-peak ที่ 1584, 1580, 1582, 1582 และ 1581 โดย D-peak ้ดังกล่าวแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของแผ่นกราฟืนหรือความไม่เป็นระเบียบของอะตอมการ์บอนใน ้ชั้นกราฟีน และ G-peak แสดงถึงลักษณะ โครงสร้างของชั้นกราฟีนของท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งค่า ความไม่สมบูรณ์ของท่อนาโนการ์บอนหาได้จากอัตราส่วนระหว่างความเข้มของพืก ${
m I}_{
m D}/{
m I}_{
m G}$ พบว่าค่า ${
m I_D}/{
m I_G}$ ของตัวอย่าง N0, N1, N2, N3 และ N4 มีก่าเท่ากับ 0.57, 0.60, 0.56, 0.76 และ 0.48 ตามลำคับ ้ดังแสดงสเปกตรัมรามานในภาพที่ 29 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเปอร์เซ็นต์โดย ้ จำนวนอะตอมของรูปแบบโครงสร้างในโตรเจนจาก XPS กับ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความไม่ ้สมบูรณ์ของระนาบกราฟีนในโครงสร้างท่อนาโนคาร์บอน ด้วยเทคนิคของรามานสเปกโทรสโกปี พบว่าในตัวอย่าง N3 ที่มีค่า I_v/I_c มากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงผลที่ทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีค่าความไม่ ้สมบรณ์ของระนาบกราฟีนสงสด สาเหตเนื่องจากมีการแทรกตัวของอะตอมในโตรเจนบริเวณ ้ โครงสร้างท่อนาโนคาร์บอนได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง N2 ที่รูปแบบ ้ โครงสร้างในโตรเจนใกล้เคียงกับตัวอย่าง N3 โดยผลที่ต่างกันที่ทำให้ตัวอย่าง N3 มีค่า ${
m I_p/I_G}$ มาก ที่สุดคือการเกิด โครงสร้างแบบ Pyrrolic nitrogen การเกิด โครงสร้างแบบ Pyrrolic nitrogen จะทำ ให้อะตอมของในโตรเจนเข้าไปแทรกตัวและสร้างโครงสร้างกับอะตอมการ์บอนในรูปแบบวง แหวนแบบห้าเหลี่ยม ส่งผลทำให้ท่อนาโนคาร์บอนเกิดความบกพร่องทางโครงสร้างกราฟืนขึ้น ซึ่ง ้เด่นกว่าการแทนที่ของอะตอมที่ทำให้เกิดโครงสร้างในโตรเจนแบบ Pyridinic nitrogen ในลักษณะ โครงสร้างแบบหกเหลี่ยม (Ding, Song, Cheng, Liu, Chen, & Tan, 2014)



ภาพที่ 29 สเปกตรัมรามานของท่อนาโนการ์บอนของตัวอย่าง No, N1, N2 , N3 และ N4



4.2 การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน

ภาพที่ 30 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนกับสนามไฟฟ้าของ ท่อนาโนคาร์บอนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งบนวัสคุรองรับ

ผลการศึกษาสมบัติของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าของท่อนาโน การ์บอนที่เรียงตัวในแนวตั้งบนวัสดุรองรับ พบว่า แนวโน้มของสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการ ปลดปล่อยของอิเล็กตรอนจากท่อนาโนการ์บอนมีค่าลดลง เมื่อท่อนาโนการ์บอนมีปริมาณของการ เงือในโตรเจนเพิ่มขึ้นดังแสดงในภาพที่ 30 จากการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของตัวอย่าง N0 ที่ไม่ถูก เงือด้วยในโตรเจน สังเกตได้ว่า ท่อนาโนการ์บอนเริ่มมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอน เมื่อค่า สนามไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 8.76 V/μm ขณะที่ตัวอย่าง N1, N2, N3 และ N4 มีก่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้ เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอยู่ที่ประมาณ 6.62 V/μm, 6.06 V/μm, 4.81 V/μm และ 4.40 V/μm ตามลำดับ จากผลการลดลงของสนามไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดการปลดปล่อยของอิเล็กตรอนบริเวณ ปลายท่อนาโนการ์บอนนั้น เกิดจากการที่ท่อนาโนการ์บอนมีปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นนำไฟฟ้า เพิ่มขึ้น เนื่องจากอะตอมของในโตรเจนที่ถูกเงือเข้าไปในท่อนาโนการ์บอนมีผลด่อปริมาณจำนวน พาหะ โดยอะตอมไนโตรเจนทำให้เกิดอิเล็กตรอนโดเนอร์และสถานะโดเนอร์จะมีก่าเข้าใกล้ ระดับเฟอร์มิ ขณะเดียวกันมีการเลื่อนของระดับพลังงานเฟอร์มิเกิดขึ้น ทำให้อิเล็กตรอนในสถานะ โดเนอร์ง่ายต่อการเกลื่อนที่ไปยังชั้นนำไฟฟ้า ส่งผลทำให้ท่อนาโนการ์บอนมีการปลดปล่อย อิเล็กตรอนที่ดีขึ้นเมื่อถูกเงือด้วยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 31 ความสัมพันธ์ของกราฟในรูปสมการของ Fowler-Nordheim (F-N) ของท่อนาโนคาร์บอน ที่มีการเรียงตัวในแนวตั้งบนวัสคุรองรับ

จากภาพที่ 31 เมื่อพิจารณาความชั้นของกราฟกับสมการ F-N สามารถเขียนสมการให้อยู่ ในรูปที่ง่ายต่อการคำนวณดังสมการ

$$\ln\left(\frac{J}{E^2}\right) = \ln\left(\frac{A\beta^2}{\phi}\right) - \frac{B\phi^{3/2}}{\beta E}$$
(11)

โดยที่ **A**=1.54×10⁻⁶ (A•eV), **B**=6.83×10⁹ (eV^{-3/2}Vm⁻¹) โดย β คือค่า field enhancement factor, J ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า, E ค่าสนามไฟฟ้า และ ϕ ค่าฟังก์ชันงาน (work function) ในการคำนวณค่า β สามารถพิจารณาได้จากค่าความชันของกราฟ F-N เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณในโตรเจนจาก XPS กับผล β พบว่า ค่า β จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือในโตรเจน ในท่อนาโนคาร์บอนดังแสดงในภาพที่ 32



ภาพที่ 32 ความสัมพันธ์ปริมาณการเจือในโตรเจนกับค่า field enhancement factor

ตารางที่ 6 แสดงค่าฟังก์ชันงาน (Work function;	$oldsymbol{\phi}$) ที่ใช้ในการคำนวณและค่า eta ของท่อนาโน
คาร์บอนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ	

ค่าพึงก์ชันงาน (¢) ของ ตัวอย่าง ธาตุการ์บอน (eV) (Michaelson, 1977)	ค่า β จากการ	ค่าฟังก์ชันงาน	ค่า β จากการ	
	ท เพงกาชนุง เน ((V)	คำนวณ โดยใช้	(\$)	คำนวณ โดยใช้
	ค่าฟังก์ชันงาน	จริงที่วัดได้จาก	ค่าฟังก์ชันงาน	
	ของการ์บอน	UPS (eV)	จาก UPS	
N0	5.00	1268	5.10	1306
N1	5.00	1484	-	-
N2	5.00	1773	4.88	1710
N3	5.00	1848	-	-
N4	5.00	2023	4.84	1927

จากตารางที่ 6 แสดงก่า β ของท่อนาโนการ์บอนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้จากการ ทดสอบสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอน โดยพบว่าเมื่อพิจารณาก่า β จากการกำนวณที่ใช้ก่า ฟังก์ชันงาน φ ของธาตุการ์บอน (~5 eV) ท่อนาโนการ์บอนถูกเจือด้วยไนโตรเจนมีผลทำให้ก่า β เพิ่มขึ้นของด้วอย่าง N1, N2, N3 และ N4 เปรียบเทียบกับตัวอย่าง N0 ที่ไม่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน ซึ่ง แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก่า β ของตัวอย่าง ของตัวอย่าง N1, N2, N3 และ N4 เปรียบเทียบกับตัวอย่าง N0 ที่ไม่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน ซึ่ง แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก่า β ของตัวอย่าง ของตัวอย่าง N1, N2, N3 และ N4 นั้น อาจมีผลจากปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กวามหนาแน่นของท่อนาโนการ์บอนแต่ละตัวอย่าง ผลของกะตะลิสต์ที่ตกก้าง กวามสูงและ ลักษณะการเรียงตัวตั้งตรงของท่อนาโนการ์บอนมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยทางกายภาพที่ กล่าวข้างต้นอาจมีผลต่อค่า β ทั้งสิ้น ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลของก่า β ของท่อที่เกิดจากการ แทรกตัวของอะตอมไนโตรเจนที่มีผลต่ออิเล็กตรอนในชั้นนำไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ ตาม ภายใต้สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้นของท่อนาโนการ์บอนนั้น สามารถอธิบายได้เมื่อ มีปริมาณของการเจือไนโตรเจนเพิ่มขึ้น สามารถวัดกวามหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้สูงและพบว่าก่าสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนเริ่มหลุดนั้นจะมี ก่าลดลงด้วย

การวิเคราะห์เพิ่มเติมการวัดหาค่าฟังก์ชันงานหรือค่าพลังงานต่ำสุดที่ทำให้อิเล็กตรอน หลุด (ϕ) ของตัวอย่างบางชิ้นงาน (N0, N2 และ N4) ด้วยเทคนิก Ultraviolet photoelectron spectroscopy; UPS (ฟังก์ชันงานจาก UPS แสดงในภาคผนวก) เพื่อวิเคราะห์ถึงการที่ท่อโน การ์บอนมีจำนวนอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมีผลต่อฟังก์ชันงานและสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอน ผล การวิเคราะห์ด้วย UPS พบว่า ในตัวอย่าง N0 ที่ไม่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน ค่าฟังก์ชันงานที่วัดได้อยู่ที่ 5.10 eV โดยตัวอย่าง N2 ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน 2.69 %at. ก่าฟังชันก์งานที่วัดได้อยู่ที่ 4.88 eV และตัวอย่าง N4 ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน 4.06 %at. ก่าฟังชันก์งานขี่วัดได้อยู่ที่ 4.88 eV และตัวอย่าง N4 ที่ถูกเจือด้วยไนโตรเจน 4.06 %at. ก่าฟังก์ชันงานอยู่ที่ 4.84 eV (กำนวณก่าฟังก์ชัน งานจากสมการที่ 12 ที่ได้จากการพลอตกราฟในภาพที่ 33) สรุปได้ว่าเมื่อท่อนาการ์บอนถูกเจือด้วย ในโตรเจนจะทำให้ก่าฟังก์ชันงานลดลงและส่งผลให้ความสูงของกำแพงศักย์มีก่าลดลงด้วย เมื่อ กวามสูงของกำแพงศักย์ลดลงอิเล็กตรอนของแหล่งกำเนิดเมื่อถูกกระตุ้นจากพลังงานภายนอก อิเล็กตรอนจะมีโอกาสหลุดได้ง่ายขึ้น สอดกล้องกับสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโน การ์บอนในการทดลองที่ใช้ก่าสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนได้สูงกว่าท่อนาโนการ์บอนที่ ไม่เจือด้วยไนโตรเจน การหาค่า Work function (**\$**s) ของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ที่ได้วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS)



ภาพที่ 33 กราฟ (a) E_{cut off} ของ ตัวอย่าง N0, (b) E_{cut off} ของ ตัวอย่าง N2, (c) E_{cut off} ของตัวอย่าง N4 และกราฟ (d) ค่า E_F

ค่า Work function ($oldsymbol{\phi}_{
m s}$) หาใด้จากการฟลอตกราฟและแทนค่าในสมการ (12)

$$\Phi_{\rm s} = hv - (E_{\rm F} - E_{\rm Cut off})$$
(12)

้ โคยสมการที่ (12) คือ Work Function = พลังงานจากแสงทั้งหมด – พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน

Sample	Work function ($\mathbf{\Phi}_{s}$)	hv	E _F	E cut off
N0	5.10	40	45.78	10.88
N2	4.88	40	45.78	10.66
N4	4.84	40	45.78	10.62

ตารางที่ 7 แสดงค่า Work function และค่าที่ใช้ในการคำนวณ

4.3 ผลการวัดความต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอน



ภาพที่ 34 ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง

ผลการศึกษาการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนจากกราฟในภาพที่ 34 ก่าความต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนตัวอย่างที่วัดภายใต้อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที พบว่าก่าความต้านทานของท่อนาโนการ์บอนที่วัดได้มีความเสถียรตลอดการวัด โดยก่าความ ต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอนสรุปได้ดังตารางที่ 6

ตัวอย่าง	$R_0(\Omega)$	$\Delta R\left(\Omega\right)$
N0	128.14	-27.11
N1	97.57	-11.50
N2	87.89	-10.14
N3	56.07	-3.15
N4	36.53	-4.35

ตารางที่ 8 แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้



ภาพที่ 35 ก่าความต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนการ์บอนแต่ละตัวอย่างช่วงอุณหภูมิ 25 – 130 °C

ผลการทดสอบการวัดค่าความต้ำนทานไฟฟ้าของตัวอย่างท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ กับฟังก์ชันอุณหภูมิในช่วง 25–130 °C ดังแสดงในภาพที่ 35 ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคงที่ ประมาณ 8.6 °C/min เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีค่าลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุกตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้แสดงสมบัติพฤติกรรมในรูปแบบสารกึ่งตัวนำ สาเหตุเนื่องมาจาก อิเล็กตรอนบางส่วนจากแถบวาเลนซ์ (Valence band) เคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในแถบนำไฟฟ้า (Conduction band) ได้ ขณะเดียวกันการลดลงของความต้านทานทางไฟฟ้า เกิดจากผลของ อิเล็กตรอนในชั้นแถบนำไฟฟ้ามีปริมาณอิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของ อิเล็กตรอนในชั้นโดเนอร์ (donor state) ไปยังชั้นแถบนำไฟฟ้า เนื่องจากในสารกึ่งตัวนำเมื่อมีการ เจืออะตอมให้เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดไม่บริสุทธิ์ อะตอมของสารที่เจือเข้าไปทำให้เกิดอิเล็กตรอน โดเนอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างแถบนำไฟฟ้ากับแถบวาเลนซ์ เมื่อสารกึ่งตัวนำได้รับความร้อนจากภายนอก อิเล็กตรอนในชั้นพลังงานโดเนอร์จะกระโดดขึ้นไปยังแถบนำไฟฟ้าและนำไฟฟ้าได้ ซึ่งกรณีของ ท่อนาโนการ์บอนที่ไม่ถูกเจือด้วยในโตรเจนไม่มีอิเล็กตรอนโดเนอร์ จึงต้องใช้พลังงานมากกว่าใน การกระตุ้นเพื่อให้อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์เคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในแถบนำไฟฟ้า ในตัวอย่าง N3 และ N4 ปริมาณการเจือในโตรเจนมีปริมาณที่สูง ทำให้เกิดอิเล็กตรอนในชั้นโดเนอร์สูงกว่า N1 และ N2 ซึ่งมีผลทำให้ใช้พลังงานกระตุ้นด้วยความร้อนที่ต่ำเพื่อเคลื่อนอิเล็กตรอนไปยังชั้นนำไฟฟ้า โดยสังเกตเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าเกิดขึ้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เมื่อมี การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

การประยุกต์ใช้ท่อนาโนการ์บอนกับวัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณา กวามต้านทานกับอุณหภูมิ พบว่า กวามต้านทานจะมีก่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สังเกตได้ว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีลักษณะพฤติกรรมกล้ายเทอร์มิสเตอร์ (Thermister) โดยเทอร์มิสเตอร์เป็นตัว วัดอุณหภูมิแบบสารกึ่งตัวนำที่ใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปแต่ จะมีทั้งการเปลี่ยนได้ทั้งแบบแปรผันตรงและแปรผกผัน เทอร์มิสเตอร์จะมีลักษณะ 2 แบบ คือ เทอร์ มิสเตอร์ที่มีสัมประสิทธิ์กวามต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นบวก (Positive Temperature Coefficient, PTC) และเทอร์มิสเตอร์ที่มีสัมประสิทธิ์กวามต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นบวก (Negative Temperature Coefficient, NTC) และตัวอย่างที่สังเกราะห์ได้เมื่อพิจารณาตามลักษณะการลดลงของก่ากวาม ด้านทานไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น พบว่ามีลักษณะเด่นกล้ายเทอร์มิสเตอร์ในรูปแบบ NTC จาก ข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ท่อนาโนการ์บอนที่สังเกราะห์ได้เหมาะที่จะนำไปศึกษาต่อ สำหรับเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้ เช่นกัน

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

จากงานวิจัยได้ทำการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและการปลคปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนาม ของท่อนาโนการ์บอนที่เจือด้วยในโตรเจนที่มีการเรียงตัวในแนวตั้ง ผลสรุปได้ดังนี้

- การศึกษาการเจือในโตรเจนที่มีต่อโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน พบท่อนาโนคาร์บอน ที่สังเคราะห์ได้มีความยาวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณสารตั้งต้นอิมิดาโซล โครงสร้าง ภายในของท่อนาโนคาร์บอนที่ไม่ถูกเจือด้วยในโตรเจนมีลักษณะแบบทรงกลมกลวง มี ผนังของท่อที่หนา โดยที่ท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกเจือด้วยในโตรเจนมีลักษณะโครงสร้าง ภายในแบบคล้ายปล้องไผ่ มีผนังของท่อที่บาง และตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณ เปอร์เซ็นต์ในโตรเจน โดยจำนวนอะตอมในโตรเจนของตัวอย่างสูงสุดอยู่ที่ 4.06 at%
- ผลการวิเคราะห์ด้วยรามานสเปกโตรสโกปีมีความสอดคล้องกับผลของ XPS ซึ่งชี้ให้เห็น ว่า ค่าความไม่สมบูรณ์ (I_D/I_G) ของระนาบกราฟีนสูงสุด มาจากการเกิดโครงสร้างแบบ Pyrrolic nitrogen ซึ่งอยู่ในรูปแบบวงแหวนแบบห้าเหลี่ยม มีค่าเค่นกว่าค่าความไม่สมบูรณ์ ที่เกิดจากการแทนที่ของอะตอมที่ทำให้เกิดโครงสร้างในโตรเจนแบบ Pyridinic nitrogen ในลักษณะโครงสร้างแบบหกเหลี่ยม
- การศึกษาสนามไฟฟ้าเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนการ์บอนที่ เจือด้วยปริมานไนโตรเจนที่แตกต่างกัน พบว่าเมื่อท่อนาโนการ์บอนถูกเจือด้วยปริมาน ในโตรเจนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าสนามไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนมีค่า ลดลงและมีก่า field enhancement factor เพิ่มตามการเพิ่มของปริมานการเจือในโตรเจน
- ผลการวิเคราะห์ค่าฟังก์ชันงานด้วย UPS แสดงให้เห็นว่าการเงือท่อนาโนคาร์บอนด้วย ในโตรเงนทำให้ค่าฟังก์ชันงานมีค่าลดลง
- การศึกษาความด้านทานทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงของท่อนาโนคาร์บอนที่เจือด้วย ในโตรเจนที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง พบว่าทุกตัวอย่างที่ สังเคราะห์ได้แสดงสมบัติพฤติกรรมในรูปแบบสารกึ่งตัวนำ

ข้อเสนอแนะ

- จากกระบวนการสังเคราะห์กวรมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสังเคราะห์ เพื่อลดปริมาณ ของโลหะคะตะลิสต์ที่ตกค้างให้ได้มากที่สุด เพราะผลของโลหะคะตะลิสต์ที่ตกค้างที่มาก เกินไป ซึ่งอาจมีผลต่อสมบัติด้านต่าง ๆ ของท่อนาโนการ์บอน
- ควรมีการศึกษาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนเพิ่มเติมในเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ความหนาแน่นของ ท่อนาโนการ์บอน ผลของคะตะลิสต์ที่ตกค้าง ลักษณะความสูงและลักษณะการเรียงตัวตั้ง ของท่อนาโนการ์บอนในลักษณะที่แตกต่างกัน
- กวรมีศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์ความด้านทาน (Temperature Coefficient of Resistance; TCR) ของท่อนาโนคาร์บอนเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจัยของขนาดและความยาวท่อนาโน คาร์บอนมีผลต่อสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนด้วยเช่นกัน

บรรณานุกรม

- Ávila, A. F., & Lacerda, G. S. R. (2008). Molecular mechanics applied to single-walled carbon nanotubes. *Materials Research*, *11*, 325-333.
- Ayala, P., Arenal, R., Rummeli, M., Rubio, A., & Pichler, T. (2010). The doping of carbon nanotubes with nitrogen and their potential applications. *Carbon, 48*, 575–586.
- Bajpai, V., Dai, L., & Ohashi, T. (2004). Large-scale synthesis of perpendicularly aligned helical carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, 126, 5070– 5071.
- Biddinger, E.J., Deak, D.V., & Ozkan, U.S. (2009). Nitrogencontaining carbon nanostructures as oxygen-reduction catalysts. *Top. Catal*, 52, 1566–1574.
- Bonard, J.M., Kind, H., Stockli, T., & Nilsson, L.O. (2001). Field emission from carbon nanotubes: the first five years. *Solid-State Electronics*, 45, 839-914.
- Bonard, J.M., Kurt, R., & Klink, C. (2001). Influence of the deposition conditions on the field emission properties of patterned nitrogenated carbon nanotube films. *Chemical Physics Letters*, 343, 21-27.
- Cheng, Y., & Zhou, O. (2003). Electron field emission from carbon nanotubes. *Comptes Rendus Physique, 4*, 1021–1033.
- Cole, M.T., Nakamoto, M., & Milne, W.I. (2015). Field Emission Displays (FEDs) and surfaceconduction Electron-Emitter Displays (SEDs). In M. Kriss (Ed.), *Handbook of Digital Imaging.* n.p. :John Wiley & Sons.

Cruz-Silva, E., Cullen, D.A., Gu, L., Romo-Herrera, J.M., Muñoz-Sandoval, E., López-Urías,
F., Sumpter, B.G., Meunier, V., Charlier, J.-C., Smith, D.J., Terrones, H., &
Terrones, M. (2008). Heterodoped nanotubes: Theory, synthesis, and
characterization of phosphorus-nitrogen doped multiwalled carbon nanotubes.
ACS Nano, 2, 441–448.

- Czerw, R., Terrones, M., Charlier, J.-C., Blase, X., Foley, B., Kamalakaran, R., Grobert, N., Terrones, H., Tekleab, D., Ajayan, P.M., Blau, W., Ruhle, M., & Carroll, D.L. (2001). Identification of electron donor states in N-doped carbon nanotubes. *Nano Lett*, *9*, 457-460.
- Deepak, F.L., John, N.S., Govindaraj, A., Kulkarni, G.U., & Rao, C.N.R. (2005). Nature and electronic properties of Y-junctions in CNTs and N-doped CNTs obtained by the pyrolysis of organometallic precursors . *Chemical Physics Letters*, 411, 468–473.
- Demczyk, B.G., Wang, Y.M., Cumings, J., Hetman, M., Han, W., Zettl, A., & Ritchie, R.O.
 (2002). Direct mechanical measurement of the tensile strength and elastic modulus of multiwalled carbon nanotubes. *Materials Science and Engineering A, 334*, 173–178.
- Ding, D., Song, Z.-L., Cheng, Z.-Q., Liu, W.-N., Nie, X.-K., Bian, X., Chen, Z., & Tan, W. (2014). Plasma-assisted nitrogen doping of graphene-encapsulated Pt nanocrystals as efficient fuel cell catalysts. *Journal of Materials Chemistry A*, 2, 472-477.
- Droppa Jr, R., Hammer, P., Carvalho, A.C.M., dos Santos, M.C., & Alvarez, F. (2002). Incorporation of nitrogen in carbon nanotubes. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 299–302, 874–879.
- Edwardsa, E.R., Antunesb, E.F., Botelhoa, E.C., Baldanb, M.R., & Corat, E.J. (2011). Evaluation of residual iron in carbon nanotubes purified by acid treatments. *Applied Surface Science*. 641-846.
- Ewels, C.P., & Glerup, M. (2005). Nitrogen doping in carbon nanotubes. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, 5, 1345-1363.
- Feng, J., Li, Y., Hou, F., & Zhong, X. (2008). Controlled growth of high quality bamboo carbon nanotube arrays by the double injection chemical vapor deposition process. *Materials Science and Engineering: A, 473*, 238–243.
- Fowler, R. H., & Nordheim, L. (1928). Electron Emission in Intense Electric Fields. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 119, 173-181.

- Ghosh, K., Kumar, M., Maruyama, T., & Ando, Y. (2010). Controllable growth of highly Ndoped carbon nanotubes from imidazole: a structural, spectroscopic and field emission study. *Journal of Materials Chemistry*, 20, 4128–4134.
- Ghosh, P., Soga, T., Ghosh, K., Afre, R.A., Jimbo, T., & Ando, Y. (2008). Vertically aligned Ndoped carbon nanotubes by spray pyrolysis of turpentine oil and pyridine derivative with dissolved ferrocene. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 354, 4101–4106.
- Ghosh, P., Tanemura, M., Soga, T., Zamri, M., & Jimbo, T. (2008). Field emission property of N-doped aligned carbon nanotubes grown by pyrolysis of monoethanolamine. *Solid State Communications*, 147, 15–19.
- Guo, T., Nikolaev, A., Thess, A., Colbert, D. T., & Smalley, R. E. (1995). Catalytic growth of single-walled nanotubes by laser vaporization. *Chemical Physics Letters*, 243, 49-54.
- Han, W., Kohler-Redlich, P., Seeger, T., Ernst, F., Ruhle, M., Grobert, N., Hsu, W.-K.,
 Chang, B.-H., Zhu, Y.-Q., Kroto, H.W., Walton, D.R.M., Terrones, M., & Terrones, H.
 (2000). Aligned CN_x nanotubes by pyrolysis of ferrocene/C₆₀ under NH₃
 atmosphere. *Applied Physics Letters*, 77, 1807–1809.
- Ibrahim, E.M.M., Khavrus, V.O., Leonhardt, A., Hampel, S., Oswald, S., Rümmeli, M.H., & Büchner, B. (2010). Synthesis, characterization, and electrical properties of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes with different nitrogen content. *Diamond & Related Materials, 19*, 1199–1206.
- Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. Nature, 354, 56-58.
- Jiang, K., Eitan, A., Schadler, L.S., Ajayan, P.M., Siegel, R.W., Grobert, N., Mayne, M., Terrones, H., & Terrones, M. (2003). Selective attachment of gold nanoparticles to nitrogen-doped carbon nanotubes. *Nano Letters*, 3, 275–277.
- Kang, D.W., & Suh, J.S. (2004). Fabrication temperature effect of the field emission from closed and open tip carbon nanotube arrays fabricated on anodic aluminum oxide films. *Journal of Applied Physics*, 96, 5234.

- Kim, N.S., Lee, Y.T., Park, J., Han, J.B., Choi, Y.S., Choi, S.Y., Choo, J., & Lee, G.H. (2003). Vertically aligned carbon nanotubes grown by pyrolysis of iron, cobalt, and nickel phthalocyanines. *The Journal of Physical Chemistry B*, 107, 9249–9255.
- Koo's, A.A., Dowling, M., Jurkschat, K., Crossley, A., & Grobert, N. (2009). Effect of the experimental parameters on the structure of nitrogen-doped carbon nanotubes produced by aerosol chemical vapour deposition. *Carbon, 47*, 30–37.
- Kudashov, A.G., Okotrub, A.V., Bulusheva, L.G., Asanov, I.P., Shubin, Y.V., Yudanov, N.F.,
 Yudanova, L.I., Danilovich, V.S., & Abrosimov, O.G. (2004). Influence of Ni-Co
 catalyst composition on nitrogen content in carbon nanotubes. *J. Phys. Chem. B*,
 108, 9048–9053.
- Kumar, M. (2011). Carbon Nanotube Synthesis and Growth Mechanism. In S. Yellampalli (Ed.), Carbon Nanotubes - Synthesis, Characterization, Applications (p. 148). InTech.
- Kunadian, I., Lipka, S.M., Swartz, C.R., Dali, Q., & Adrews, R. (2009). Determination of carrier densities of boron- and nitrogen-doped multiwalled carbon nanotubes using mott-schottky plots. *Journal of The Electrochemical Society*, 156, K110–K115.
- Lau, K.-H., & Hui, D. (2002). The revolutionary creation of new advanced materials-carbon nanotube composites. *Composites Part B: Engineering*, *33*, 263-277.
- Lee, C.J., Lyu, S.C., Kim, H.-W., Lee, J.H., & Cho, I.C. (2002). Synthesis of bamboo-shaped carbon–nitrogen nanotubes using C₂H₂–NH₃–Fe(CO)₅ system. *Chemical Physics Letters*, 359, 115–120.
- Letsoala, P.J., Cele, L.M., Nxumalo, E.N., & Coville, N.J. (2010). The influence of nitrogen sources on nitrogen doped multi-walled carbon nanotubes. *Journal of Organometallic Chemistry*, 695, 2596-2602.
- Liang, E.J., Ding, P., Zhang, H.R., Guo, X.Y., & Du, Z.L. (2004). Synthesis and correlation study on the morphology and Raman spectra of CNx nanotubes by thermal decomposition of ferrocene/ethylenediamine. *Diamond and Related Materials*, 13, 69–73.

- Liang, S.-J., & Ang, L.K. (2015). Electron thermionic emission from graphene and a thermionic energy converter. *Physical Review Applied*, *3*, 014002.
- Li, C., & Chou, T,-W. (2003). Elastic moduli of multi-walled carbon nanotubes and the effect of van der Waals forces. *Composites Science and Technology*, 63, 1517–1524.
- Li, J.C., Wang, Y., & Ba, D.C. (2012). Characterization of semiconductor surface conductivity by using microscopic four-point probe technique. *Physics Procedia*, 32, 347 – 355.
- Liu, H., Zhang, Y., Li, R., Sun, X., Désilets, S., Abou-Rachid, H., Jaidann, M., & Lussier, L.S. (2010). Structural and morphological control of aligned nitrogen-doped carbon nanotubes. *Carbon, 48*, 1498–1507.
- Liu, J., Czerw, R., & Carroll, D.L. (2005). Large-scale synthesis of highly aligned nitrogen doped carbon nanotubes by injection chemical vapor deposition methods. *Journal of Materials Research*, 20, 538–543.
- Liu, J., Webster, S., & Carroll, D.L. (2005). Temperature and flow rate of NH₃ effects on nitrogen content and doping environments of carbon nanotubes grown by injection CVD method. *The Journal of Physical Chemistry B*, 109, 15769–15774.
- Li, Y.L., Hou, F., Yang, Z.T., Feng, J.M., Zhong, X.H., & Li, J.Y. (2009). The growth of Ndoped carbon nanotube arrays on sintered Al₂O₃ substrates. *Materials Science and Engineering: B, 158*, 69–74.
- Luo, Z., Lim, S., Tian, Z., Shang, J., Lai, L., MacDonald, B., Fu, C., Shen, Z., Yu, T., & Lin, J. (2011). Pyridinic N doped graphene: synthesis, electronic structure, and electrocatalytic property. *Journal of Materials Chemistry*, 21, 8038.
- Maciel, I.O., Campos-Delgado, J., Cruz-Silva, E., Pimenta, M.A., Sumpter, B.G., Meunier, V., Lo'pez-Uri'as, F., Mun~oz-Sandoval, E., Terrones, H., Terrones, M., & Jorio, A. (2009). Synthesis, electronic structure, and Raman scattering of phosphorus-doped single-wall carbon nanotubes. *Nano Letters*, *9*, 2267–2272.

- Maldonado, S., Morin, S., & Stevenson, K.J. (2006). Structure, composition, and chemical reactivity of carbon nanotubes by selective nitrogen doping. *Carbon, 44*, 1429–1437.
- Merchan, W.M., Saveliev, A.V., Kennedy, L., & Jimenez, W.C. (2010). Combustion synthesis of carbon nanotubes and related nanostructures. *Progress in Energy and Combustion Science*, 36, 696-727.
- Michaelson, H.B. (1977). The work function of the elements and its periodicity. J. Appl. Phys, 48, 4729.
- Nxumalo, E.N., & Coville, N.J. (2010). Nitrogen Doped Carbon Nanotubes from Organometallic Compounds: A Review. *Materials, 3*, 2141-2171.
- Nxumalo, E.N., Nyamori, V.O., & Coville, N.J. (2008). CVD synthesis of nitrogen doped carbon nanotubes using ferrocene/aniline mixtures. *Journal of Organometallic Chemistry*, 693, 2942–2948.
- Puretzky, A. A., Geohegan, D. B., Jesse, S., Ivanov, I. N., & Eres, G. (2005). In situ measurements and modeling of carbon nanotube array growth kinetics during chemical vapor deposition. *Applied Physics A*, 81, 223-240.
- Reyes, M.-R., Grobert, N., Kamalakaran, R., Seeger, T., Golberg, D., Ru"hle, M., Bando, Y., Terrones, H., & Terrones, M. (2004). Efficient encapsulation of gaseous nitrogen inside carbon nanotubes with bamboo-like structure using aerosol thermolysis. *Chemical Physics Letters, 396*, 167–173.
- Shah, M.S., Li, R., Sun, X., & Ye, S. (2009). 3-D composite electrodes for high performance PEM fuel cells composed of Pt supported on nitrogen-doped carbon nanotubes grown on carbon paper. *Electrochemistry Communications*, 11, 438–441.
- Sen, R., Satishkumar, B.C., Govindaraj, A., Harikumar, K.R., Renganathan, M.K., & Rao, C.N.R. (1997). Nitrogen-containing carbon nanotubes. *Journal of Materials Chemistry*, 7, 2335–2337.
- Terrones, M., Grobert, N., & Terrones, H. (2002). Synthetic routes to nanoscale B_xC_yN_z architectures. *Carbon, 40*, 1665–1684.

- Villalpando-Paez, F., Zamudio, A., Elias, A.L., Son, H., Barros, E.B., Chou, S.G., Kim, Y.A., Muramatsu, H., Hayashi, T., Kong, J., Terrones, H., Dresselhaus, G., Endo, M., Terrones, M., & Dresselhaus, M.S. (2006). Synthesis and characterization of long strands of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes. *Chemical Physics Letters*, 424, 345–352.
- Wang, M.S., Wang, J.Y., & Peng, L.-M. (2006). Engineering the cap structure of individual carbon nanotubes and corresponding electron field emission characteristics. *Applied Physics Letters*, 88, 243108.
- Wang, X., Hu, W., Liu, Y., Long, C., Xu, Y., Zhou, S., Zhu, D., & Dai, L. (2001). Bamboo-like carbon nanotubes produced by pyrolysis of iron(II) phthalocyanine. *Carbon, 39*, 1533–1536.
- Wang, X., Liu, Y., Zhu, D., Zhang, L., Ma, H., Yao, N., & Zhang, B. (2002). Controllable Growth, Structure, and Low Field Emission of Well-Aligned CNx Nanotubes. J. Phys. Chem. B, 106, 2186–2190.
- Xu, E., Wei, J., Wang, K., Li, Z., Gui, X., Jia, Y., Zhu, H., & Wu, D. (2010). Doped carbon nanotube array with a gradient of nitrogen concentration. *Carbon, 48*, 3097-3102.
- Yadav, R.M., Dobal, P.S., Shripathi, T., Katiyar, R.S., & Srivastava, O.N. (2009). Effect of growth temperature on bamboo-shaped carbon–nitrogen (C–N) nanotubes synthesized using ferrocene acetonitrile precursor. *Nanoscale Research Letters, 4*, 197–203.
- Yang, Q., Xu, W., Tomita, A., & Kyotani, T. (2005). The Template synthesis of double coaxial carbon nanotubes with nitrogen-doped and boron-doped multiwalls. J. Am. Chem. Soc, 127, 8956-8957.
- Yu, M.-F., Lourie, O., Dyer, MJ., Moloni, K., Kelly, TF., & Ruoff, RS. (2000). strength and breaking mechanism of multiwalled carbon nanotubes under tensile load. *Science*, 287(5453), 637-640.
- Zhang, Y., Gu, H., Suenaga, K., & Iijirna, S. (1997). Heterogeneous growth of B-C-N nanotubes by laser ablation. *Chemical Physics Letters*, 279, 264-269